

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 9 月 23 日 (23.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/082006 A1(51) 国際特許分類⁷:
5/00, B23K 26/38 // 101:40

H01L 21/301, B28D

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福満 憲志 (FUKUMITSU, Kenshi) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 福世 文嗣 (FUKUYO, Fumitsugu) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 内山 直己 (UCHIYAMA, Naoki) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/011626

(22) 国際出願日: 2003 年 9 月 11 日 (11.09.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-67276 2003 年 3 月 12 日 (12.03.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).

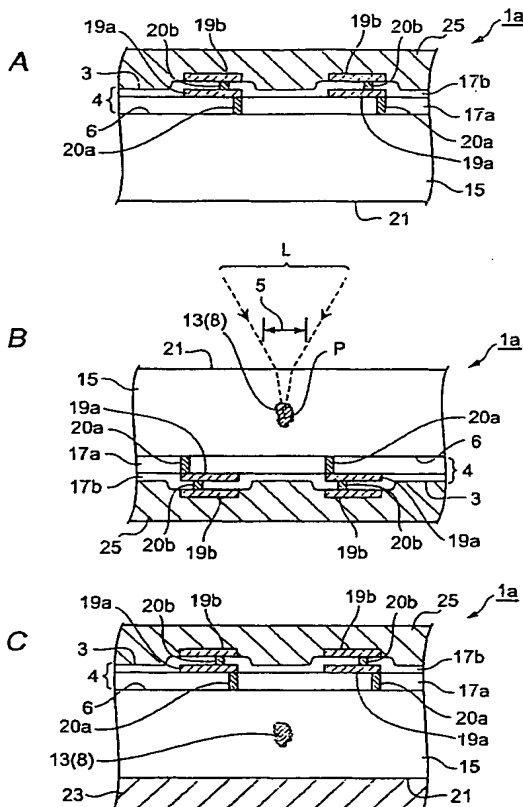
(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目10番6号 銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

(続葉有)

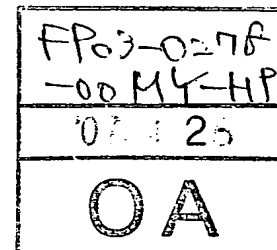
(54) Title: LASER BEAM MACHINING METHOD

(54) 発明の名称: レーザ加工方法



(57) Abstract: The invention provides a laser beam machining method characterized by comprising the steps of mounting a protective tape (25) on the surface (3) of a wafer (1a), radiating laser light (L) by using the back (21) of a wafer (1a) as a laser light incidence plane with an optical converging point (P) positioned in a substrate (15) to thereby form a melt processing region (13) for melt processing by multiphoton absorption, forming, by means of the melt processing region (13), a cutting start region (8) on the side within a predetermined distance from the laser light incidence plane along a predetermined cutting line (5) on the wafer (1a), mounting an expand tape (23) on the back (21) of the wafer (1a), and stretching the expand tape (23) to thereby separate a plurality of chip-like portions (24) from each other that are formed by the wafer (1a) being cut with the cutting start region (8) used as the starting point.

(57) 要約: 本発明は、ウェハ 1a の表面 3 に保護テープ 25 を装着し、ウェハ 1a の裏面 21 をレーザ光入射面として基板 15 の内部に集光点 P を合わせてレーザ光 L を照射することにより多光子吸収による溶融処理領域 13 を形成し、この溶融処理領域 13 によって、ウェハ 1a の切断予定ライン 5 に沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域 8 を形成し、ウェハ 1a の裏面 21 にエキスパンドテープ 23 を装着し、切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1a が切断されることにより生じた複数のチップ状部分 24 を、エキスパンドテープ 23 を伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とするレーザ加工方法を提供する。



WO 2004/082006 A1



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

レーザ加工方法

技術分野

【0001】 本発明は、加工方法、特にレーザを用いた加工方法に関する。

5 背景技術

【0002】 近年、半導体デバイス用として Al_2O_3 基板上にGaN等の半導体動作層を結晶成長させたものや、液晶表示装置用としてガラス基板上に他のガラス基板を貼り合わせたもの等、種々の積層構造を有する加工対象物を高精度に切断する技術が求められている。

10 【0003】 従来、これらの積層構造を有する加工対象物の切断には、ブレードダイシング法やダイヤモンドスクライプ法が使用されるのが一般的である。

【0004】 ブレードダイシング法とは、ダイヤモンドブレード等により加工対象物を切削して切断する方法である。一方、ダイヤモンドスクライプ法とは、
15 ダイヤモンドポイントツールにより加工対象物の表面にスクライプラインを設け、このスクライプラインに沿うよう加工対象物の裏面にナイフエッジを押し当てて、加工対象物を割って切断する方法である。

【0005】 しかしながら、ブレードダイシング法にあつては、例えば、加工対象物が上述した液晶表示装置用のものである場合、ガラス基板と他のガラス基板との間に間隙が設けられているため、この間隙に削り屑や潤滑洗浄水が入り込
20 んでしまうおそれがある。

【0006】 また、ダイヤモンドスクライプ法にあつては、加工対象物が Al_2O_3 基板等の硬度の高い基板を有している場合や、或いは、加工対象物がガラス基板同士を貼り合わせたものである場合等に、加工対象物の表面だけでなく裏面にもスクライプラインを設けなければならず、この表面と裏面とに設けられたス
25 クライプラインの位置ずれによって切断不良が生じるおそれがある。

発明の開示

【0007】 そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、上述したような問題を解決し、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても加工対象物を高精度に切断することのできるレーザ加工方法を提供することを目的とする。

5 【0008】 上記目的を達成するために、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、
10 加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、切断起点領域を起点として加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とする。

15 【0009】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、半導体基板と、半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を
20 形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、切断起点領域を起点として加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備えることを特徴とする。

25 【0010】 これらのレーザ加工方法によれば、加工対象物の表面に保護フィルムを装着することによって、加工対象物を裏面を上にして台上に載置することができるので、加工対象物の裏面から（半導体）基板の内部にレーザ光を好適に照射することができる。そして、多光子吸収という現象により形成される改質領

域（熔融処理領域）でもって、加工対象物を切断すべき所望の切断予定ラインに沿った切断起点領域を基板の内部に形成し、この切断起点領域を起点として加工対象物を切断することができる。そして、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着してこれを伸張させることにより、切断された加工対象物の複数の部分を容易に分離することができる。すなわち、本レーザ加工方法によれば、加工対象物の表面にある積層部にレーザ光を直接照射せずに切断起点領域を形成できるとともに、切断起点領域を起点として基板を比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断された加工対象物を容易に分離することができる。従って、このレーザ加工方法によれば、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。

【0011】 ここで、基板上の積層部とは、基板の表面に堆積されたもの、基板の表面に貼り合わされたもの、或いは基板の表面に取り付けられたもの等をいい、基板に対し異種材料であるか同種材料であるかは問わない。そして、積層部には、基板に密着して設けられるものや、基板と間隙を取って設けられるもの等がある。例としては、基板上に結晶成長により形成された半導体動作層や、ガラス基板上に貼り合わされた他のガラス基板等があり、積層部は異種材料を複数層形成したものも含む。また、基板の内部とは、積層部が設けられている基板の表面上をも含む意味である。さらに、集光点とは、レーザ光が集光した箇所のことである。そして、切断起点領域は、改質領域が連続的に形成されることで形成される場合もあるし、改質領域が断続的に形成されることで形成される場合もある。

【0012】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加

工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、加工対象物に外力を印加することにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断し、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

5 【0013】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、加工対象物に外力を印加することにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断し、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

10 【0014】 これらのレーザ加工方法によれば、上述したレーザ加工方法と同様の理由により、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。また、加工対象物を複数の部分に切断する際に加工対象物に外力を印加することによって、切断起点領域を起点として加工対象物を容易に切断することができる。

15 【0015】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、基板と、基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、伸張性のフィルムを伸張させるこ

とにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断するとともに加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

【0016】 また、本発明に係るレーザ加工方法は、半導体基板と、半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、加工対象物の積層部側の表面に保護フィルムを装着し、加工対象物の裏面をレーザ光入射面として半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより溶融処理領域を形成し、この溶融処理領域によって、加工対象物の切断予定ラインに沿ってレーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、伸張性のフィルムを伸張させることにより切断起点領域を起点として加工対象物を複数の部分に切断するとともに加工対象物の複数の部分を分離する工程を備えることを特徴とする。

【0017】 これらのレーザ加工方法によれば、上述したレーザ加工方法と同様の理由により、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。また、伸張性のフィルムを伸張させることにより、加工対象物の切断起点領域に引張応力が印加されるので、加工対象物を切断する工程と複数の部分を分離する工程とを同時に行うことができ、製造工程を削減することができる。

【0018】 また、上述した本発明に係るレーザ加工方法においては、加工対象物に切断起点領域を形成する前に、加工対象物の基板が薄くなるように加工対象物の裏面を研削することが好ましい。これによって、切断起点領域を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせずに加工対象物を精度良く切断することができる。

【0019】 また、上述した本発明に係るレーザ加工方法においては、伸張性のフィルムを加工対象物に装着した後、保護フィルムを除去することが好ましい。これによって、切断起点領域が形成された加工対象物を離散させることなく保持することができる。或いは、伸張性のフィルムを伸張させることにより加工対象

物の複数の部分を分離した後、保護フィルムを除去することが好ましい。これによって、加工対象物を切断してから複数の部分を取り出すまでの間、該複数の部分を保護することができる。

図面の簡単な説明

- 5 図 1 は、本実施形態に係るレーザ加工方法によるレーザ加工中の加工対象物の平面図である。
- 図 2 は、図 1 に示す加工対象物の II-II 線に沿った断面図である。
- 図 3 は、本実施形態に係るレーザ加工方法によるレーザ加工後の加工対象物の平面図である。
- 10 図 4 は、図 3 に示す加工対象物の IV-IV 線に沿った断面図である。
- 図 5 が、図 3 に示す加工対象物の V-V 線に沿った断面図である。
- 図 6 は、本実施形態に係るレーザ加工方法により切断された加工対象物の平面図である。
- 図 7 は、本実施形態に係るレーザ加工方法における電界強度とクラックスポットの大きさとの関係を示すグラフである。
- 15 図 8 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 1 工程における加工対象物の断面図である。
- 図 9 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 2 工程における加工対象物の断面図である。
- 20 図 10 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 3 工程における加工対象物の断面図である。
- 図 11 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 4 工程における加工対象物の断面図である。
- 図 12 は、本実施形態に係るレーザ加工方法により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。
- 25 図 13 は、本実施形態に係るレーザ加工方法におけるレーザ光の波長とシリ

コン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。

図 1 4 は、本実施形態に係るレーザ加工装置の概略構成図である。

図 1 5 は、本実施形態に係るレーザ加工方法において用いられるウェハを示す斜視図である。

5 図 1 6 は、図 1 5 に示されたウェハの平面図である。

図 1 7 は、図 1 6 に示されたウェハの VI-VI 断面及び VII-VII 断面を示す拡大図である。

図 1 8 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 1 実施例を説明するためのフローチャートである。

10 図 1 9 は、図 1 4 に示されたレーザ加工装置を用いてウェハに切断起点領域を形成する方法を示すフローチャートである。

図 2 0 A-2 0 C は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

15 図 2 1 A-2 1 C は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

図 2 2 は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

図 2 3 は、第 1 実施例に係るレーザ加工方法の変形例を説明するための断面図である。

20 図 2 4 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 2 実施例を説明するためのフローチャートである。

図 2 5 A-2 5 C は、第 2 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

25 図 2 6 A-2 6 C は、第 2 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面図である。

図 2 7 は、第 2 実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハの断面

図である。

図 28 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 3 実施例を説明するためのフローチャートである。

図 29 は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第 4 実施例を説明するための
5 フローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

【0020】 以下、図面と共に本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。本実施形態に係るレーザ加工方法では、加工対象物の内部に多光子吸収による改質領域を形成する。そこで、このレーザ加工方法、特に多光子吸収について
10 最初に説明する。

【0021】 材料の吸収のバンドギャップ E_G よりも光子のエネルギー $h\nu$ が小さいと光学的に透明となる。よって、材料に吸収が生じる条件は $h\nu > E_G$ である。しかし、光学的に透明でも、レーザ光の強度を非常に大きくすると $n h\nu > E_G$ の条件 ($n = 2, 3, 4, \dots$) で材料に吸収が生じる。この現象を多
15 光子吸収という。パルス波の場合、レーザ光の強度はレーザ光の集光点のピークパワー密度 (W/cm^2) で決まり、例えばピークパワー密度が 1×10^8 (W/cm^2) 以上の条件で多光子吸収が生じる。ピークパワー密度は、(集光点におけるレーザ光の 1 パルス当たりのエネルギー) \div (レーザ光のビームスポット断面積 \times パルス幅) により求められる。また、連続波の場合、レーザ光の強度は
20 レーザ光の集光点の電界強度 (W/cm^2) で決まる。

【0022】 このような多光子吸収を利用する本実施形態に係るレーザ加工の原理について、図 1 ～図 6 を参照して説明する。図 1 はレーザ加工中の加工対象物 1 の平面図であり、図 2 は図 1 に示す加工対象物 1 の II-II 線に沿った断面
25 図であり、図 3 はレーザ加工後の加工対象物 1 の平面図であり、図 4 は図 3 に示す加工対象物 1 の IV-IV 線に沿った断面図であり、図 5 は図 3 に示す加工対象物 1 の V-V 線に沿った断面図であり、図 6 は切断された加工対象物 1 の平面図

である。

【0023】 図1及び図2に示すように、加工対象物1の面10には、加工対象物1を切断すべき所望の切断予定ライン5がある。切断予定ライン5は直線状に延びた仮想線である（加工対象物1に実際に線を引いて切断予定ライン5としてもよい）。本実施形態に係るレーザ加工は、多光子吸収が生じる条件で加工対象物1の内部に集光点Pを合わせてレーザ光Lを加工対象物1に照射して改質領域7を形成する。なお、集光点とはレーザ光Lが集光した箇所のことである。また、加工対象物1の面10はレーザ光が入射されるレーザ光入射面となっており、該面10においてレーザ光Lが散乱することを防ぐため、平坦かつ滑面であることが好ましい。

【0024】 レーザ光Lを切断予定ライン5に沿って（すなわち矢印A方向に沿って）相対的に移動させることにより、集光点Pを切断予定ライン5に沿って移動させる。これにより、図3～図5に示すように改質領域7が切断予定ライン5に沿って加工対象物1の内部にのみ形成され、この改質領域7でもって切断起点領域8が形成される。本実施形態に係るレーザ加工方法は、加工対象物1がレーザ光Lを吸収することにより加工対象物1を発熱させて改質領域7を形成するのではない。加工対象物1にレーザ光Lを透過させ加工対象物1の内部に多光子吸収を発生させて改質領域7を形成している。よって、加工対象物1の面10ではレーザ光Lがほとんど吸収されないので、加工対象物1の面10が溶融することはない。

【0025】 加工対象物1の切断において、切断する箇所に起点があると加工対象物1はその起点から割れるので、図6に示すように比較的小さな力で加工対象物1を切断することができる。よって、加工対象物1の面10に不必要な割れを発生させることなく加工対象物1の切断が可能となる。

【0026】 さて、本実施形態において多光子吸収により形成される改質領域としては、次の（1）～（3）がある。

(1) 改質領域が1つ又は複数のクラックを含むクラック領域の場合

基板（例えばサファイア、ガラス、または LiTaO_3 からの圧電材料）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が 1×10^8 (W/cm^2) 以上で且つパルス幅が $1 \mu\text{s}$ 以下の条件でレーザー光を照射する。このパルス幅の大きさは、多光子吸収を生じさせつつ基板の面に余計なダメージを与えずに、基板の内部にのみクラック領域を形成できる条件である。これにより、基板の内部には多光子吸収による光学的損傷という現象が発生する。この光学的損傷により基板の内部に熱ひずみが誘起され、これにより基板の内部にクラック領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば 1×10^{12} (W/cm^2) である。パルス幅は例えば $1 \text{ ns} \sim 200 \text{ ns}$ が好ましい。

【0027】 本発明者は、電界強度とクラックの大きさとの関係を実験により求めた。実験条件は下記の通りである。

(A) 基板：パイレックス（登録商標）ガラス（厚さ $700 \mu\text{m}$ ）

(B) レーザ

光源：半導体レーザー励起Nd：YAGレーザー

波長： 1064 nm

レーザー光スポット断面積： $3.14 \times 10^{-8} \text{ cm}^2$

発振形態：Qスイッチパルス

繰り返し周波数： 100 kHz

パルス幅： 30 ns

出力：出力 $< 1 \text{ mJ}$ /パルス

レーザー光品質： TEM_{00}

偏光特性：直線偏光

(C) 集光用レンズ

レーザー光波長に対する透過率： 60 パーセント

(D) 基板が載置される載置台の移動速度： $100 \text{ mm}/\text{秒}$

【0028】 なお、レーザ光品質がTEM₀₀とは、集光性が高くレーザ光の波長まで集光可能を意味する。

【0029】 図7は上記実験の結果を示すグラフである。横軸はピークパワー密度であり、レーザ光がパルスレーザ光なので電界強度はピークパワー密度で表される。縦軸は1パルスのレーザ光により基板の内部に形成されたクラック部分（クラックスポット）の大きさを示している。クラックスポットが集まりクラック領域となる。クラックスポットの大きさは、クラックスポットの形状のうち最大の長さとなる部分の大きさである。グラフ中の黒丸で示すデータは集光用レンズ（C）の倍率が100倍、開口数（NA）が0.80の場合である。一方、グラフ中の白丸で示すデータは集光用レンズ（C）の倍率が50倍、開口数（NA）が0.55の場合である。ピークパワー密度が 10^{11} (W/cm²)程度から基板の内部にクラックスポットが発生し、ピークパワー密度が大きくなるに従いクラックスポットも大きくなることが分かる。

【0030】 次に、本実施形態に係るレーザ加工において、クラック領域形成による加工対象物の切断のメカニズムについて図8～図11を用いて説明する。図8に示すように、多光子吸収が生じる条件で加工対象物1の内部に集光点Pを合わせてレーザ光Lを加工対象物1に照射して切断予定ラインに沿って内部にクラック領域9を形成する。クラック領域9は1つ又は複数のクラックを含む領域である。このクラック領域9でもって切断起点領域が形成される。図9に示すように、人為的な力（例えば引張応力）を加工対象物1に印加することにより、クラック領域9を起点として（すなわち、切断起点領域を起点として）クラックがさらに成長し、図10に示すようにクラックが加工対象物1の両面に到達し、図11に示すように加工対象物1が割れることにより加工対象物1が切断される。

【0031】 （2）改質領域が熔融処理領域の場合

基板（例えばシリコンのような半導体材料）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が 1×10^8 (W/cm²)以上で且つパルス幅が1μs以下の

条件でレーザ光を照射する。これにより基板の内部は多光子吸収によって局所的に加熱される。この加熱により基板の内部に熔融処理領域が形成される。熔融処理領域とは一旦熔融後再固化した領域や、まさに熔融状態の領域や、熔融状態から再固化する状態の領域であり、相変化した領域や結晶構造が変化した領域ということもできる。また、熔融処理領域とは単結晶構造、非晶質構造、多結晶構造において、ある構造が別の構造に変化した領域ということもできる。つまり、例えば、単結晶構造から非晶質構造に変化した領域、単結晶構造から多結晶構造に変化した領域、単結晶構造から非晶質構造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域を意味する。基板がシリコン単結晶構造の場合、熔融処理領域は例えば非晶質シリコン構造である。電界強度の上限値としては、例えば 1×10^{12} (W/cm²) である。パルス幅は例えば 1 ns ~ 200 ns が好ましい。

【0032】 本発明者は、シリコンウェハの内部で熔融処理領域が形成されることを実験により確認した。実験条件は次の通りである。

(A) 基板：シリコンウェハ（厚さ 350 μm、外径 4 インチ）

(B) レーザ

光源：半導体レーザ励起 Nd : YAG レーザ

波長：1064 nm

レーザ光スポット断面積：3.14 × 10⁻⁸ cm²

発振形態：Qスイッチパルス

繰り返し周波数：100 kHz

パルス幅：30 ns

出力：20 μJ / パルス

レーザ光品質：TEM₀₀

偏光特性：直線偏光

(C) 集光用レンズ

倍率：50 倍

N. A. : 0. 5 5

レーザ光波長に対する透過率 : 6 0 パーセント

(D) 基板が載置される載置台の移動速度 : 1 0 0 mm/秒

5 【0033】 図12は、上記条件でのレーザ加工により切断されたシリコンウェハの一部における断面の写真を表した図である。シリコンウェハ11の内部に溶融処理領域13が形成されている。なお、上記条件により形成された溶融処理領域13の厚さ方向の大きさは100 μ m程度である。

10 【0034】 溶融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを説明する。図13は、レーザ光の波長とシリコン基板の内部の透過率との関係を示すグラフである。ただし、シリコン基板の表面側と裏面側それぞれの反射成分を除去し、内部のみの透過率を示している。シリコン基板の厚さtが50 μ m、100 μ m、200 μ m、500 μ m、1000 μ mの各々について上記関係を示した。

15 【0035】 例えば、Nd : YAGレーザの波長である1064nmにおいて、シリコン基板の厚さが500 μ m以下の場合、シリコン基板の内部ではレーザ光が80%以上透過することが分かる。図12に示すシリコンウェハ11の厚さは350 μ mなので、多光子吸収による溶融処理領域13をシリコンウェハ11の中心付近に形成すると、シリコンウェハ11の表面から175 μ mの部分に形成される。この場合の透過率は、厚さ200 μ mのシリコンウェハを参考にすると、90%以上なので、レーザ光がシリコンウェハ11の内部で吸収されるのは僅か
20 であり、ほとんどが透過する。このことは、シリコンウェハ11の内部でレーザ光が吸収されて、溶融処理領域13がシリコンウェハ11の内部に形成（つまりレーザ光による通常の加熱で溶融処理領域が形成）されたものではなく、溶融処理領域13が多光子吸収により形成されたことを意味する。

25 【0036】 なお、シリコンウェハは、溶融処理領域でもって形成される切断起点領域を起点として断面方向に向かって割れを発生し、その割れがシリコンウェハの両面に到達することにより、結果的に切断される。発明者らの考察によれ

ば、熔融処理領域を起点とした亀裂が生じるのは、熔融処理領域とそれ以外の領域との物性的な違いによってシリコンウェハの内部に歪みが生じ易くなる為だと考えられる。また、図12に示された写真からも判るように、熔融処理領域13の上下には尖頭状の熔融痕が存在する。この熔融痕によって、熔融処理領域を起点とした亀裂が精度良くシリコンウェハの両面に到達するものと考えられる。また、熔融処理領域はシリコンウェハの内部のみに形成され、切断後の切断面には、図12のように内部にのみ熔融処理領域が形成されている。基板の内部に熔融処理領域でもって切断起点領域を形成すると、切断時、切断起点領域ラインから外れた不必要な割れが生じにくいので、切断制御が容易となる。

10 【0037】 (3) 改質領域が屈折率変化領域の場合

基板（例えばガラス）の内部に集光点を合わせて、集光点における電界強度が 1×10^8 (W/cm²) 以上で且つパルス幅が 1 ns 以下の条件でレーザ光を照射する。パルス幅を極めて短くして、多光子吸収を基板の内部に起こさせると、多光子吸収によるエネルギーが熱エネルギーに転化せずに、基板の内部にはイオン価数変化、結晶化又は分極配向等の永続的な構造変化が誘起されて屈折率変化領域が形成される。電界強度の上限値としては、例えば 1×10^{12} (W/cm²) である。パルス幅は例えば 1 ns 以下が好ましく、1 ps 以下がさらに好ましい。

15 【0038】 以上、多光子吸収により形成される改質領域として(1)～(3)の場合を説明したが、加工対象物の結晶構造やその劈開性を考慮して切断起点領域を次のように形成すれば、その切断起点領域を起点として、より一層小さな力で、しかも精度良く加工対象物を切断することが可能になる。

20 【0039】 すなわち、シリコンなどのダイヤモンド構造の単結晶半導体からなる基板の場合は、(111)面(第1劈開面)や(110)面(第2劈開面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。また、GaAsなどの閃亜鉛鉱型構造のIII-V族化合物半導体からなる基板の場合は、(110)面に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。さらに、サファイア(Al

$2O_3$)などの六方晶系の結晶構造を有する基板の場合は、(0001)面(C面)を主面として(1120)面(A面)或いは(1100)面(M面)に沿った方向に切断起点領域を形成するのが好ましい。

【0040】なお、基板として例えば円盤状のウェハを切断する場合、上述した切断起点領域を形成すべき方向(例えば、単結晶シリコン基板における(111)面に沿った方向)、或いは切断起点領域を形成すべき方向に直交する方向に沿ってウェハにオリエンテーションフラットを形成すれば、そのオリエンテーションフラットを基準とすることで、切断起点領域を形成すべき方向に沿った切断起点領域を容易且つ正確にウェハに形成することが可能になる。

【0041】次に、上述したレーザ加工方法に使用されるレーザ加工装置について、図14を参照して説明する。図14はレーザ加工装置100の概略構成図である。

【0042】レーザ加工装置100は、レーザ光Lを発生するレーザ光源101と、レーザ光Lの出力やパルス幅等を調節するためにレーザ光源101を制御するレーザ光源制御部102と、レーザ光Lの反射機能を有しかつレーザ光Lの光軸の向きを90°変えるように配置されたダイクロイックミラー103と、ダイクロイックミラー103で反射されたレーザ光Lを集光する集光用レンズ105と、集光用レンズ105で集光されたレーザ光Lが照射される加工対象物1が載置される載置台107と、載置台107をX軸方向に移動させるためのX軸ステージ109と、載置台107をX軸方向に直交するY軸方向に移動させるためのY軸ステージ111と、載置台107をX軸及びY軸方向に直交するZ軸方向に移動させるためのZ軸ステージ113と、これら3つのステージ109, 111, 113の移動を制御するステージ制御部115とを備える。

【0043】この集光点PのX(Y)軸方向の移動は、加工対象物1をX(Y)軸ステージ109(111)によりX(Y)軸方向に移動させることにより行う。Z軸方向は、加工対象物1の面10と直交する方向なので、加工対象物

1に入射するレーザ光Lの焦点深度の方向となる。よって、Z軸ステージ113をZ軸方向に移動させることにより、加工対象物1の内部にレーザ光Lの集光点Pを合わせることができる。

【0044】 レーザ光源101はパルスレーザ光を発生するNd:YAGレーザである。レーザ光源101に用いることができるレーザとして、この他、Nd:YVO₄レーザ、Nd:YLFレーザやチタンサファイアレーザがある。本実施形態では、加工対象物1の加工にパルスレーザ光を用いているが、多光子吸収を起こさせることができるなら連続波レーザ光でもよい。

【0045】 レーザ加工装置100はさらに、載置台107に載置された加工対象物1を可視光線により照明するために可視光線を発生する観察用光源117と、ダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105と同じ光軸上に配置された可視光用のビームスプリッタ119とを備える。ビームスプリッタ119と集光用レンズ105との間にダイクロイックミラー103が配置されている。ビームスプリッタ119は、可視光線の約半分を反射し残りの半分を透過する機能を有しかつ可視光線の光軸の向きを90°変えるように配置されている。観察用光源117から発生した可視光線はビームスプリッタ119で約半分が反射され、この反射された可視光線がダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105を透過し、加工対象物1の切断予定ライン5等を含む面10を照明する。

【0046】 レーザ加工装置100はさらに、ビームスプリッタ119、ダイクロイックミラー103及び集光用レンズ105と同じ光軸上に配置された撮像素子121及び結像レンズ123を備える。撮像素子121としては例えばCCDカメラがある。切断予定ライン5等を含む面10を照明した可視光線の反射光は、集光用レンズ105、ダイクロイックミラー103、ビームスプリッタ119を透過し、結像レンズ123で結像されて撮像素子121で撮像され、撮像データとなる。

【0047】 レーザ加工装置100はさらに、撮像素子121から出力された

撮像データが入力される撮像データ処理部 125 と、レーザ加工装置 100 全体を制御する全体制御部 127 と、モニタ 129 とを備える。撮像データ処理部 125 は、撮像データを基にして観察用光源 117 で発生した可視光の焦点を加工対象物 1 の面 10 上に合わせるための焦点データを演算する。この焦点データを基にしてステージ制御部 115 が Z 軸ステージ 113 を移動制御することにより、可視光の焦点が加工対象物 1 の面 10 に合うようにする。よって、撮像データ処理部 125 はオートフォーカスユニットとして機能する。また、撮像データ処理部 125 は、撮像データを基にして面 10 の拡大画像等の画像データを演算する。この画像データは全体制御部 127 に送られ、全体制御部で各種処理がなされ、モニタ 129 に送られる。これにより、モニタ 129 に拡大画像等が表示される。

【0048】 全体制御部 127 には、ステージ制御部 115 からのデータ、撮像データ処理部 125 からの画像データ等が入力し、これらのデータも基にしてレーザ光源制御部 102、観察用光源 117 及びステージ制御部 115 を制御することにより、レーザ加工装置 100 全体を制御する。よって、全体制御部 127 はコンピュータユニットとして機能する。

【0049】 次に、上述したレーザ加工装置 100 を用いた、本実施形態に係るレーザ加工方法について説明する。図 15 は、本実施形態に係るレーザ加工方法における加工対象物であるウェハ 1a を示す斜視図である。また、図 16 は、図 15 に示されたウェハ 1a の底面図である。また、図 17 は、図 16 に示されたウェハ 1a の VI-VI 断面及び VII-VII 断面を示す拡大図である。

【0050】 図 15～図 17 を参照すると、ウェハ 1a は、平板状であり略円盤状を呈している。図 16 を参照すると、ウェハ 1a の裏面 21 には縦横に交差する複数の切断予定ライン 5 が設定されている。切断予定ライン 5 は、ウェハ 1a を複数のチップ状部分に切断するために想定される仮想線である。この切断予定ライン 5 は、例えばウェハ 1a の劈開面に沿って想定されるとよい。

【0051】 また、ウェハ 1a は、オリエンテーションフラット（以下「O

F」 という) 19を有している。本実施形態では、OF 19は縦横に交差する切断予定ライン5のうちの一方向と平行な方向を長手方向として形成されている。OF 19は、ウェハ1aを切断予定ライン5に沿って切断する際に、切断方向を容易に判別する目的で設けられている。

- 5 【0052】 また、図17を参照すると、ウェハ1aは、半導体(Si)からなる基板15と、基板15の表面6上に積層された積層部4を備えている。積層部4は、絶縁性材料(SiO₂)からなる層間絶縁層17a及び17b、並びに金属(W)からなる第1の配線層19a及び第2の配線層19bを有している。層間絶縁層17aは基板15の表面6上に積層されており、表面6上に複数互いに分割されて設定された素子形成領域上に第1の配線層19aが積層されている。
- 10 第1の配線層19a及び基板15は、層間絶縁層17aを貫通するように設けられたプラグ20aによって互いに電氣的に接続されている。層間絶縁層17bは層間絶縁層17a及び第1の配線層19a上に積層されており、層間絶縁層17b上であって第1の配線層19aに対応する領域に第2の配線層19bが積層されている。第2の配線層19b及び第1の配線層19aは、層間絶縁層17bを貫通するように設けられたプラグ20bによって互いに電氣的に接続されている。
- 15

- 【0053】 層間絶縁層17b上であって第2の配線層19b同士の隙間にある領域には、切断予定ライン5が想定される。この切断予定ライン5においては、層間絶縁層17bの表面(すなわち、ウェハ1aの表面3)が平坦かつ滑面となっている。
- 20

【0054】 (第1の実施例)

【0055】 図18及び図19は、本実施形態に係るレーザ加工方法の第1実施例を説明するためのフローチャートである。また、図20～図22は、本実施例に係るレーザ加工方法を説明するためのウェハ1aの断面図である。

- 25 【0056】 図18を参照すると、まず、ウェハ1aの表面3に積層部4を保護するための保護フィルムとして保護テープ25を装着する(S1、図20A)。

保護テープ 25 の材料としては、積層部 4 を保護する緩衝効果を有しており積層部 4 の動作特性に影響がなければ様々な材料を用いることができる。本実施形態では、保護テープ 25 の材料として、衝撃を吸収するとともに紫外線を照射することにより除去することが可能な材料を選択する。

5 【0057】 続いて、ウェハ 1 a の基板 15 の内部に、切断予定ライン 5 に沿って切断起点領域 8 を形成する (S 3、図 20B)。ここで、図 20B に示されるウェハ 1 a は、表面 3 が図の下方になるように描かれている。すなわち、ウェハ 1 a の裏面 21 における切断予定ライン 5 に対応する領域をレーザ光入射面として基板 15 の内部の集光点 P へレーザ光 L を照射することにより、基板 15 の
10 内部に改質領域として熔融処理領域 13 を形成する。この熔融処理領域 13 が、ウェハ 1 a を切断する際の切断起点領域 8 となる。

15 【0058】 ここで、図 19 は、図 14 に示されたレーザ加工装置 100 を用いてウェハ 1 a に切断起点領域 8 を形成する方法を示すフローチャートである。なお、本実施形態において、ウェハ 1 a は、レーザ加工装置 100 の載置台 107 に、裏面 21 が集光用レンズ 105 と対向するように配置される。すなわち、レーザ光 L は、ウェハ 1 a の裏面 21 から入射される。

20 【0059】 図 14 及び図 19 を参照すると、まず、基板 15 の光吸収特性を図示しない分光光度計等により測定する。この測定結果に基づいて、基板 15 に対して透明な波長又は吸収の少ない波長のレーザ光 L を発生するレーザ光源 101 を選定する (S 101)。

25 【0060】 続いて、基板 15 の厚さ、材質、及び屈折率等を考慮して、ウェハ 1 a の Z 軸方向の移動量を決定する (S 103)。これは、ウェハ 1 a の裏面 21 から所定距離内側の所望の位置にレーザ光 L の集光点 P を合わせるために、ウェハ 1 a の裏面 21 に位置するレーザ光 L の集光点 P を基準としたウェハ 1 a の Z 軸方向の移動量である。この移動量は全体制御部 127 に入力される。

30 【0061】 ウェハ 1 a をレーザ加工装置 100 の載置台 107 にウェハ 1 a

の裏面 2 1 が集光用レンズ 1 0 5 側と対向するよう載置する。このとき、積層部 4 が設けられているウェハ 1 a の表面 3 には保護テープ 2 5 が装着されているので、ウェハ 1 a の表面 3 側を下にして載置台 1 0 7 に載置しても何ら問題ない。そして、観察用光源 1 1 7 から可視光を発生させてウェハ 1 a の裏面 2 1 を照明する (S 1 0 5)。照明されたウェハ 1 a の裏面 2 1 を撮像素子 1 2 1 により撮像する。撮像素子 1 2 1 により撮像された撮像データは撮像データ処理部 1 2 5 に送られる。この撮像データに基づいて撮像データ処理部 1 2 5 は、観察用光源 1 1 7 の可視光の焦点がウェハ 1 a の裏面 2 1 に位置するような焦点データを演算する (S 1 0 7)。

【0062】 この焦点データはステージ制御部 1 1 5 に送られる。ステージ制御部 1 1 5 は、この焦点データを基にして Z 軸ステージ 1 1 3 を Z 軸方向の移動させる (S 1 0 9)。これにより、観察用光源 1 1 7 の可視光の焦点がウェハ 1 a の裏面 2 1 に位置する。なお、撮像データ処理部 1 2 5 は撮像データに基づいて、切断予定ライン 5 を含む裏面 2 1 の拡大画像データを演算する。この拡大画像データは全体制御部 1 2 7 を介してモニタ 1 2 9 に送られ、これによりモニタ 1 2 9 に切断予定ライン 5 付近の拡大画像が表示される。

【0063】 全体制御部 1 2 7 には予めステップ S 1 0 3 で決定された移動量データが入力されており、この移動量データがステージ制御部 1 1 5 に送られる。ステージ制御部 1 1 5 はこの移動量データに基づいて、レーザ光 L の集光点 P の位置がウェハ 1 a の裏面 2 1 から所定距離内側となるように、Z 軸ステージ 1 1 3 によりウェハ 1 a を Z 軸方向に移動させる (S 1 1 1)。

【0064】 続いて、レーザ光源 1 0 1 からレーザ光 L を発生させて、レーザ光 L をウェハ 1 a の裏面 2 1 に照射する。レーザ光 L の集光点 P は基板 1 5 の内部に位置しているので、改質領域である熔融処理領域 1 3 は基板 1 5 の内部にのみ形成される。そして、切断予定ライン 5 に沿うように X 軸ステージ 1 0 9 や Y 軸ステージ 1 1 1 を移動させて熔融処理領域 1 3 を複数形成するか、あるいは切

断予定ライン5に沿って連続して熔融処理領域13を形成することにより、切断予定ライン5に沿う切断起点領域8を基板15の内部に形成する(S113)。

【0065】 再び図18を参照すると、ウェハ1aの裏面21に伸張性のフィルムであるエキスパンドテープ23を装着する(S5、図20C)。エキスパンドテープ23は、例えば伸張方向に力を加えることによって伸びる材料からなり、後の工程において、ウェハ1aをチップ状に分離させるために用いられる。エキスパンドテープ23としては、伸張方向に力を加えることによって伸びるもの以外にも例えば加熱により伸びるものでもよい。

【0066】 続いて、切断起点領域8に沿ってウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断する(S7、図21A)。すなわち、ウェハ1aの裏面21に装着されたエキスパンドテープ23の上から切断起点領域8にあわせてナイフエッジ33を当て、ウェハ1aに曲げ応力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1aを割断(ブレーキング)する。このとき、ウェハ1a内部には切断起点領域8から表面3及び裏面21へ達する亀裂18が生じ、基板15が切断されると同時に、層間絶縁層17a及び17bも切断される。ウェハ1aに応力を印加する手段としては、ナイフエッジ33以外にも例えばブレーキング装置、ローラー装置などがある。また、ウェハ1aの表面3や裏面21にその面が熔融しないエネルギーにてウェハ1aに対して吸収性を有するレーザ光を照射することで切断起点領域8を起点として亀裂が生じるような熱応力を発生させて切断してもよい。また、ウェハ1aの表面3に装着された保護テープ25の上からナイフエッジ33等を当てて曲げ応力を印加してもよい。

【0067】 続いて、ウェハ1aの表面3に装着された保護テープ25に紫外線Vを照射する(S9、図21B)。保護テープ25に紫外線Vを照射することによって、保護テープ25を除去可能な状態とする。そして、保護テープ25をウェハ1aの表面3から剥離する(S11、図21C)。なお、保護テープ25の剥離はウェハ1aを切断する工程(S7)の前に行っても良い。

【0068】 続いて、ウェハ1 aを個々のチップ状部分2 4に分離する（S 1 3、図2 2）すなわち、エキスパンドテープ2 3を伸張させることにより複数のチップ状部分2 4の間に間隔2 6をあける。こうすることにより、複数のチップ状部分2 4のそれぞれをピックアップし易くなる。

5 【0069】 以上説明したように、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1 aの表面3に保護テープ2 5を装着することによって、ウェハ1 aを裏面2 1を上にして載置台1 0 7上に載置することができるので、ウェハ1 aの裏面2 1から基板1 5の内部にレーザ光Lを好適に照射することができる。

10 【0070】 そして、多光子吸収という現象により形成される改質領域でもって、ウェハ1 aを切断すべき所望の切断予定ライン5に沿った切断起点領域8を基板1 5の内部に形成し、この切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを切断することができる。そして、ウェハ1 aの裏面2 1にエキスパンドテープ2 3を装着してこれを伸張させることにより、切断されたウェハ1 aの複数のチップ状部分2 4を容易に分離することができる。

15 【0071】 すなわち、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、ウェハ1 aの表面3にある積層部4にレーザ光Lを直接照射せずに切断起点領域8を形成できるので、レーザ光Lによる積層部4の損傷を防止することができる。また、基板1 5内部に切断起点領域8を形成することにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1 aを比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断されたウェハ1 a
20 を容易に分離することができる。従って、このレーザ加工方法によれば、ウェハ1 aが積層部4を有する場合においてもウェハ1 aを高精度に切断することができる。

25 【0072】 また、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、従来のブレードダイシング法などと比べてチップ状部分2 4の間のダイシング幅を格段に小さくすることができる。そして、そのようにダイシング幅を小さくした場合、個々のチップ状部分2 4同士の間隔を小さくし、より多くのチップ状部分2 4を取り出

すことが可能になる。

【0073】 また、積層部4の構成材料やレーザ光Lの照射条件などによっては、積層部4の素子形成領域にレーザ光Lが照射されないように考慮する必要がある場合がある。特に本方法では多光子吸収現象を利用するためにレーザ光Lを急激に絞り込んでいるので、積層部4の素子形成領域にレーザ光Lが照射されないようにしつつ表面3からレーザ光Lを照射することが困難な場合がある。また、一般的に、ウェハの素子形成領域間には素子用に積層された半導体層が存在することが多い。或いは、メモリや集積回路素子などにおいては素子形成領域間にTEG (Test Element Group) 等の機能素子が形成されている場合もある。

これらのような場合に、本実施例に係るレーザ加工方法を用いれば、積層部4が設けられていない裏面21からレーザ光Lを照射して基板15の内部に切断起点領域8を好適に形成することができる。

【0074】 また、本実施例に係るレーザ加工方法では、ウェハ1aにナイフエッジ33等による外力を印加することにより切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断している。これによって、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを容易に切断することができる。

【0075】 また、本実施例に係るレーザ加工方法では、エキスパンドテープ23をウェハ1aに装着した後に、保護テープ25を除去している。これによって、切断起点領域8が形成されたウェハ1aを個々のチップ状部分24に離散させることなく保持することができる。

【0076】 図23は、本実施例に係るレーザ加工方法の変形例を説明するための断面図である。本変形例では、基板15の内部において、基板15の厚さ方向に複数の溶融処理領域13を形成する。溶融処理領域13をこのように形成するには、図19に示されたフローチャートのステップS111 (ウェハをZ軸方向に移動) とステップS113 (改質領域の形成) とを交互に複数回行うとよい。また、ウェハ1aをZ軸方向に移動するのと改質領域の形成とを同時に行うこと

により、基板 15 の厚さ方向に連続して熔融処理領域 13 を形成してもよい。

本変形例のように熔融処理領域 13 を形成することにより、基板 15 の厚さ方向に延びた切断起点領域 8 を形成することができる。従って、ウェハ 1 a をより小さな力で割って切断することができる。さらに、基板 15 の厚さ方向に熔融処理領域 13 による亀裂を成長させれば、外部からの力を必要とせずウェハ 1 a を分離することもできる。

(第 2 の実施例)

【0077】 図 24 は、本実施形態によるレーザ加工方法の第 2 実施例を示すフローチャートである。また、図 25～図 27 は、本実施例を説明するためのウェハ 1 a の断面図である。本実施例と上述した第 1 実施例との相違点は、(1) 基板 15 が薄くなるように研削する点、(2) ナイフエッジ 33 等を用いたブレーキングを行わない点、(3) ウェハ 1 a を複数のチップ状部分 24 に分離した後に保護テープ 25 を剥離する点、の 3 点である。

【0078】 図 24 を参照すると、まず、ウェハ 1 a の表面 3 に保護テープ 25 を装着する (S21、図 25A)。この工程は、第 1 実施例におけるステップ S1 と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0079】 続いて、ウェハ 1 a の裏面 21 を研削する (S23、図 25B)。このとき、基板 15 の厚さを例えば 30 μ m～50 μ m まで薄くなるように研削 (グランド) する。また、次の工程においてレーザ光 L を裏面 21 から好適に入射させるために、研削後の裏面 21 が平坦かつ滑面となるように裏面 21 を研削するとよい。

【0080】 続いて、ウェハ 1 a の基板 15 の内部に、切断予定ライン 5 に沿って切断起点領域 8 を形成する (S25、図 25C)。続いて、ウェハ 1 a の研削後の裏面 21 に、エキスパンドテープ 23 を装着する (S27、図 26A)。これらの工程は、それぞれ上述した第 1 実施例におけるステップ S3 及び S5 と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0081】 続いて、エキスパンドテープ23を伸張させることにより、切断
起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するととも
に、個々のチップ状部分24を互いに分離させる（S29、図26B）。このと
き、前述したステップS23において基板15が十分に薄くなるように研削した
5 ので、エキスパンドテープ23を伸張させることによる引張応力のみによって、
切断起点領域8を起点としてウェハ1aが切断される。そして、エキスパンドテ
ープ23をそのまま伸張させることにより複数のチップ状部分24の間に間隔2
6をあける。

【0082】 続いて、保護テープ25に紫外線を照射し（S31、図26C）、
10 保護テープ25をウェハ1aの表面3から剥離する（S33、図27）。これら
の工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS9及びS11と同様
なので、詳細な説明を省略する。なお、保護テープ25の剥離はエキスパンドテ
ープ23を伸張させウェハ1aを切断する工程（S29）の前に行っても良い。

【0083】 本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第1実施例
15 と同様に、ウェハ1aの表面3にある積層部4にレーザ光Lを直接照射せずに切
断起点領域8を形成できるので、レーザ光Lによる積層部4の損傷を防止するこ
とができる。また、基板15内部に切断起点領域8を形成することにより、切断
起点領域8を起点としてウェハ1aを比較的小さな力で精度良く割って切断し、
切断されたウェハ1aを容易に分離することができる。従って、このレーザ加工
20 方法によれば、ウェハ1aが積層部4を有する場合においてもウェハ1aを高精
度に切断することができる。

【0084】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの
基板15が薄くなるようにウェハ1aの裏面21を研削している。これによって、
切断起点領域8を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせずにウ
エハ1aを切断することができる。また、基板15が比較的厚い場合に比べてよ
25 り精度良くウェハ1aを切断することができる。

【0085】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの裏面21に装着したエキスパンドテープ23を伸張させることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するとともに複数のチップ状部分24を互いに分離している。エキスパンドテープ23を伸張させる際には、ウェハ1aの切断起点領域8に引張応力が印加されるので、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを好適に切断することができる。従って、本実施形態によれば、ウェハ1aを切断する工程と、複数のチップ状部分24を互いに分離する工程とを同時に行うことができるので、製造工程を削減することができる。

【0086】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、ウェハ1aの裏面21をレーザ光入射面としてレーザ光Lを照射している。発明者らの実験によれば、熔融処理領域13などの改質領域は、基板15内部のうちレーザ光入射面側に偏って形成される傾向がある。従って、本レーザ加工方法では、エキスパンドテープ25が装着される裏面21側に偏って切断起点領域13が形成される傾向がある。一方、エキスパンドテープ23を伸張させると、基板15の裏面21付近のほうに表面6付近に比べてより大きな引張応力を印加される。従って、基板15内部において切断起点領域8が裏面21側に偏っていれば、エキスパンドテープ25を伸張させることによる引張応力をより効果的に切断起点領域8に作用させることができる。以上のことから、本実施例に係るレーザ加工方法によれば、切断起点領域8に引張応力をより効果的に作用させ、より小さな力でウェハ1aを切断することができる。

【0087】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、エキスパンドテープ23を伸張させることによりウェハ1aの複数のチップ状部分24を分離した後、保護テープ25を除去している。これによって、ウェハ1aを切断してから複数のチップ状部分24を取り出すまでの間、該複数のチップ状部分24を保護することができる。

【0088】 (第3の実施例)

【0089】 図28は、本実施形態によるレーザ加工方法の第3実施例を示すフローチャートである。本実施例と上述した第1実施例との相違点は、(1) ナイフエッジ33等を用いたプレーキングを行わない点、の1点である。本変形例では、第1実施例にて示した図20～図22を参照しながら説明する。

【0090】 図28を参照すると、まず、ウェハ1aの表面3に保護テープ25を装着する(S41、図20A)。続いて、ウェハ1aの基板15の内部に、切断予定ライン5に沿って切断起点領域8を形成する(S43、図20B)。続いて、ウェハ1aの裏面21に、エキスパンドテープ23を装着する(S45、図20C)。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS1～S5と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0091】 続いて、保護テープ25に紫外線を照射し(S47、図21B)、保護テープ25をウェハ1aの表面3から剥離する(S49、図21C)。これらの工程は、それぞれ上述した第1実施例におけるステップS9及びS11と同様なので、詳細な説明を省略する。ただし、本変形例ではナイフエッジ33による応力の印加を行わないので、図21B及び図21Cに示されている亀裂18は生じない。

【0092】 続いて、エキスパンドテープ23を伸張させることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aを複数のチップ状部分24に切断するとともに、個々のチップ状部分24を互いに分離させる(S51、図22)。このとき、本実施例では前述した第2実施例のように基板15を薄く研削していないので、エキスパンドテープ23を伸張させることによる引張応力を第2実施例よりも大きくすることにより、切断起点領域8を起点としてウェハ1aが切断される。そして、エキスパンドテープ23をそのまま伸張させることにより複数のチップ状部分24の間に間隔26をあける。

【0093】 本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第1実施例

と同様の理由により、ウェハ 1 a が積層部 4 を有する場合においてもウェハ 1 a を高精度に切断することができる。

【0094】 また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第 2 実施例と同様に、エキスパンドテープ 2 3 を伸張させることにより、切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1 a を複数のチップ状部分 2 4 に切断するとともに複数のチップ状部分 2 4 を互いに分離している。これによって、ウェハ 1 a を切断する工程と、複数のチップ状部分 2 4 を互いに分離する工程とを同時に行うことができるので、製造工程を削減することができる。

【0095】 (第 4 の実施例)

【0096】 図 2 9 は、本実施形態によるレーザ加工方法の第 4 実施例を示すフローチャートである。本実施例と上述した第 1 実施例との相違点は、(1) 基板 1 5 が薄くなるように研削する点、の 1 点である。本変形例では、第 1 実施例にて示した図 2 0 ～図 2 2 と、第 2 実施例にて示した図 2 5 とを参照しながら説明する。

【0097】 図 2 9 を参照すると、まず、ウェハ 1 a の表面 3 に保護テープ 2 5 を装着する (S 6 1、図 2 0 A)。この工程は、第 1 実施例におけるステップ S 1 と同様なので、詳細な説明を省略する。続いて、ウェハ 1 a の裏面 2 1 を研削する (S 6 3、図 2 5 B)。この工程は、第 2 実施例におけるステップ S 2 3 と同様なので、詳細な説明を省略する。続いて、ウェハ 1 a の基板 1 5 の内部に、切断予定ライン 5 に沿って切断起点領域 8 を形成する (S 6 5、図 2 5 C)。この工程は、第 1 実施例におけるステップ S 3 と同様なので、詳細な説明を省略する。

【0098】 続いて、ウェハ 1 a の裏面 2 1 に、エキスパンドテープ 2 3 を装着し (S 6 7、図 2 0 C)、ウェハ 1 a に外力を印加することにより切断起点領域 8 に沿ってウェハ 1 a を複数のチップ状部分 2 4 に切断し (S 6 9、図 2 1 A)、保護テープ 2 5 に紫外線を照射し (S 7 1、図 2 1 B)、保護テープ 2 5

をウェハ 1 a の表面 3 から剥離し (S 7 3、図 2 1 C)、エキスパンドテープ 2 3 を伸張させることにより、ウェハ 1 a の個々のチップ状部分 2 4 を互いに分離させる (S 7 5、図 2 2)。これらの工程は、それぞれ上述した第 1 実施例におけるステップ S 5 ~ S 1 3 と同様なので、詳細な説明を省略する。ただし、本実施例ではステップ S 6 3 においてウェハ 1 a の裏面 2 1 を研削しているの
5 基板 1 5 の厚さは図 2 0 C、図 2 1 A—2 1 C、及び図 2 2 に示された基板 1 5 よりも薄くなっている。なお、保護テープ 2 5 の剥離はウェハ 1 a を切断する工程 (S 6 9) の前に行っても良い。

【0 0 9 9】 本実施例に係るレーザ加工方法においては、上述した第 1 実施例
10 と同様の理由により、ウェハ 1 a が積層部 4 を有する場合においてもウェハ 1 a を高精度に切断することができる。

また、本実施例に係るレーザ加工方法においては、第 2 実施例と同様に、ウェハ 1 a の基板 1 5 が薄くなるようにウェハ 1 a の裏面 2 1 を研削している。これによって、切断起点領域 8 を起点としてより小さな力で、或いは特別な力を必要とせず
15 にウェハ 1 a をより精度良く切断することができる。

【0 1 0 0】 また、本実施例に係るレーザ加工方法では、第 1 実施例と同様に、ウェハ 1 a に外力を印加することにより切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1 a を複数のチップ状部分 2 4 に切断している。これによって、切断起点領域 8 を起点としてウェハ 1 a を容易に切断することができる。

20 【0 1 0 1】 以上、本発明の実施形態及び実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態及び実施例に限定されないことはいふまでもない。

【0 1 0 2】 例えば、上記した実施形態及び実施例においては基板として半導体基板を用いているが、本発明は半導体基板に限らず、導電性基板や絶縁性基板を有するウェハに対しても好適に適用することができる。

25 産業上の利用可能性

【0 1 0 3】 以上説明したように、本発明に係るレーザ加工方法によれば、加

- 工対象物の表面に保護フィルムを装着することによって、加工対象物を裏面を上にして台上に載置することができるので、加工対象物の裏面から基板の内部にレーザー光を好適に照射することができる。そして、多光子吸収という現象により形成される改質領域でもって、加工対象物を切断すべき所望の切断予定ラインに沿った切断起点領域を基板の内部に形成し、この切断起点領域を起点として加工対象物を切断することができる。そして、加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着してこれを伸張させることにより、切断された加工対象物の複数の部分を容易に分離することができる。すなわち、本レーザー加工方法によれば、加工対象物の表面にある積層部にレーザー光を直接照射せずに切断起点領域を形成できるとともに、切断起点領域を起点として基板を比較的小さな力で精度良く割って切断し、切断された加工対象物を容易に分離することができる。従って、このレーザー加工方法によれば、加工対象物が種々の積層構造を有する場合においても該加工対象物を高精度に切断することができる。

請求の範囲

1. 基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

5 前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記切断起点領域を起点として前記加工対象物が切断されることにより生じた複
10 数の部分を、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備える、レーザ加工方法。

2. 基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

15 前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記加工対象物に外力を印加することにより前記切断起点領域を起点として前記
20 加工対象物を複数の部分に切断し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

3. 基板と、前記基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

25 前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の前記裏面をレーザ光入射面として前記基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による改質領域を形成し、この改質領域によ

って、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断するとともに前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

5

4. 半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記切断起点領域を起点として前記加工対象物が切断されることにより生じた複数の部分を、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより互いに分離する工程を備える、レーザ加工方法。

10

15

5. 半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の裏面をレーザ光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記加工対象物に外力を印加することにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

20

25

6. 半導体基板と、前記半導体基板上に設けられた積層部とを含む平板状の加

工対象物を切断するレーザ加工方法であって、

前記加工対象物の前記積層部側の表面に保護フィルムを装着し、前記加工対象物の前記裏面をレーザ光入射面として前記半導体基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより熔融処理領域を形成し、この熔融処理領域によって、前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記レーザ光入射面から所定距離内側に切断起点領域を形成し、前記加工対象物の裏面に伸張性のフィルムを装着し、前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記切断起点領域を起点として前記加工対象物を複数の部分に切断するとともに前記加工対象物の前記複数の部分を分離する工程を備える、レーザ加工方法。

5 7. 前記加工対象物に前記切断起点領域を形成する前に、前記加工対象物の前記基板が薄くなるように前記加工対象物の前記裏面を研削する、請求項1～6のいずれか一項に記載のレーザ加工方法。

8. 前記伸張性のフィルムを前記加工対象物に装着した後、前記保護フィルムを除去する、請求項1～7のいずれか一項に記載のレーザ加工方法。

15 9. 前記伸張性のフィルムを伸張させることにより前記加工対象物の前記複数の部分に分離した後、前記保護フィルムを除去する、請求項1～7のいずれか一項に記載のレーザ加工方法。

図1

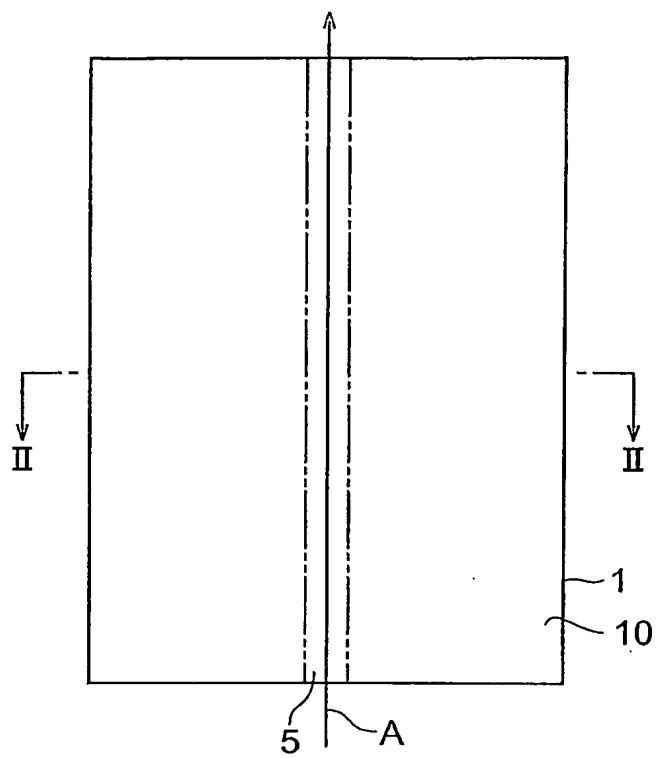


図2

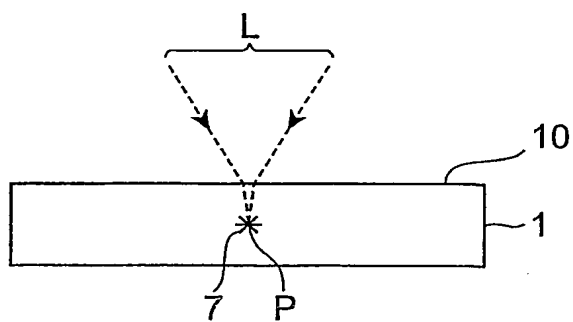


図3

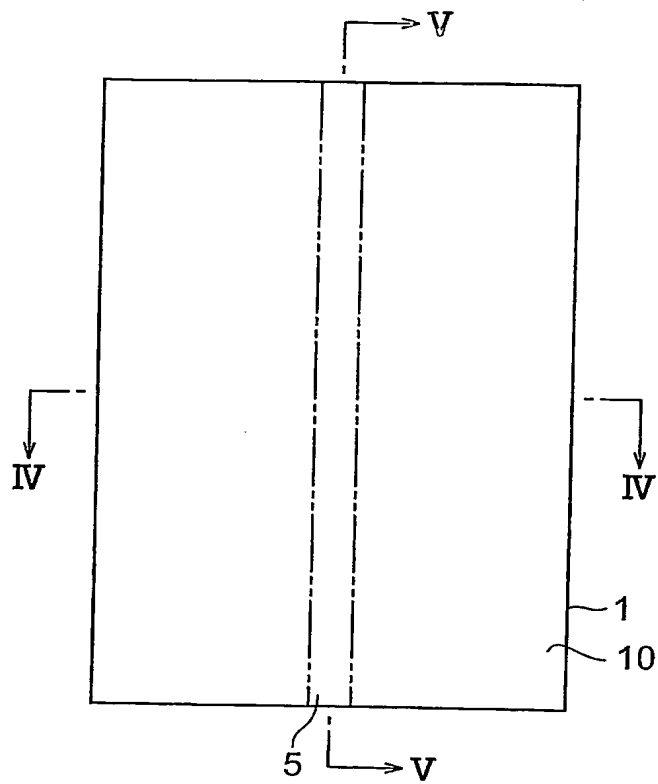


図4

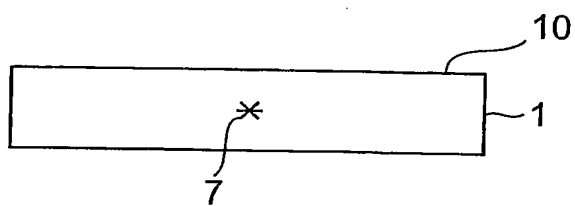


図5

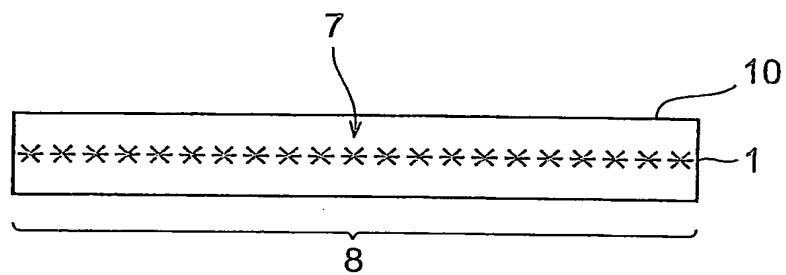


図6

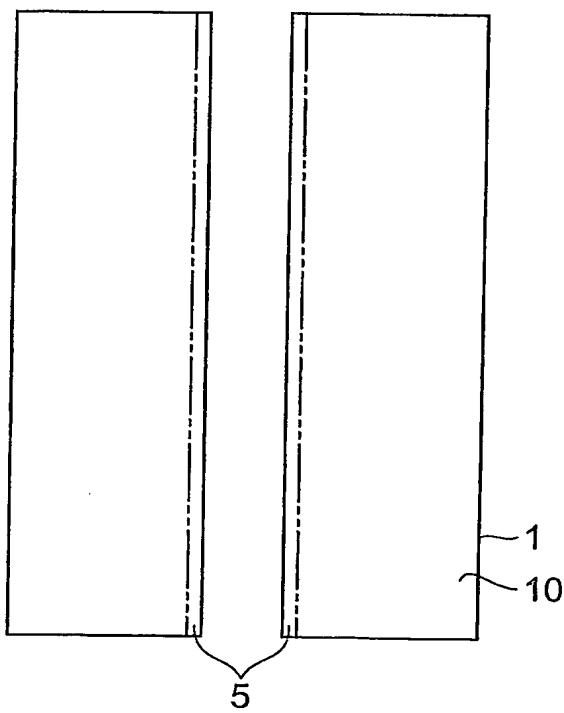


図7

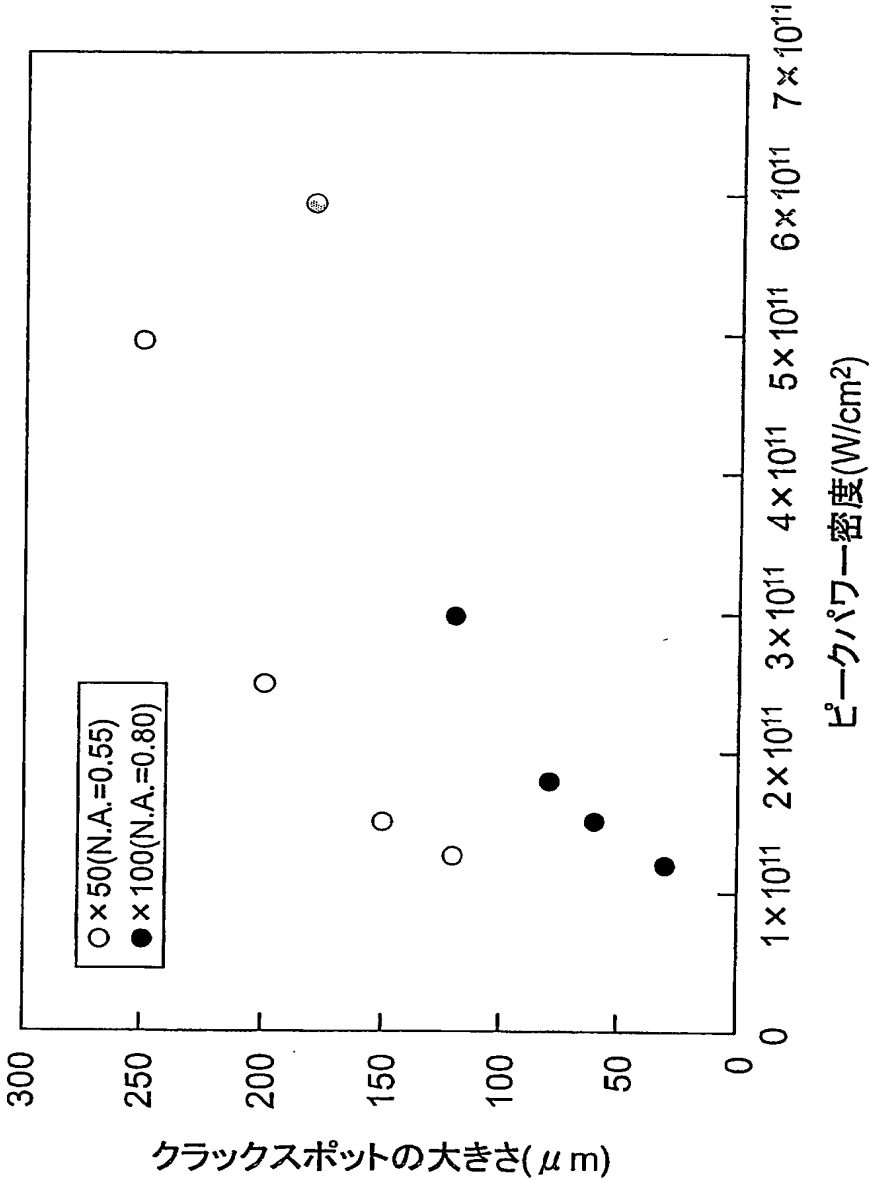


図8

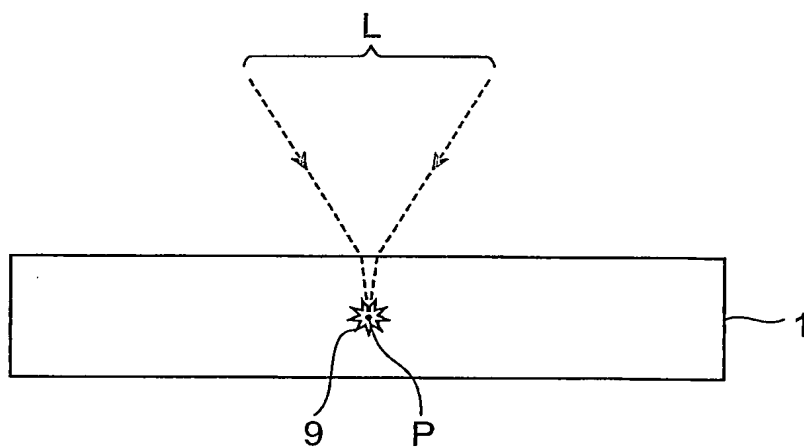


図9

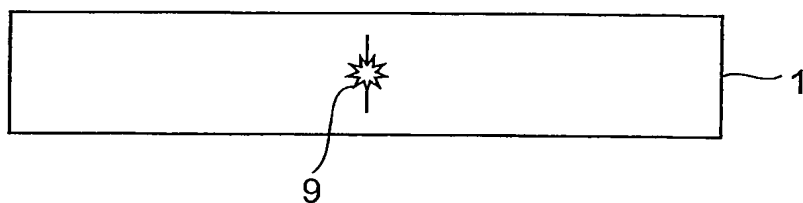


図10

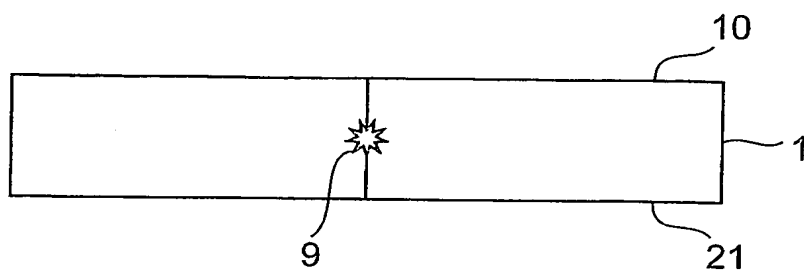
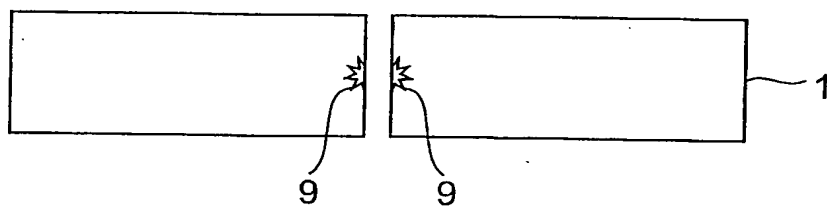


図11



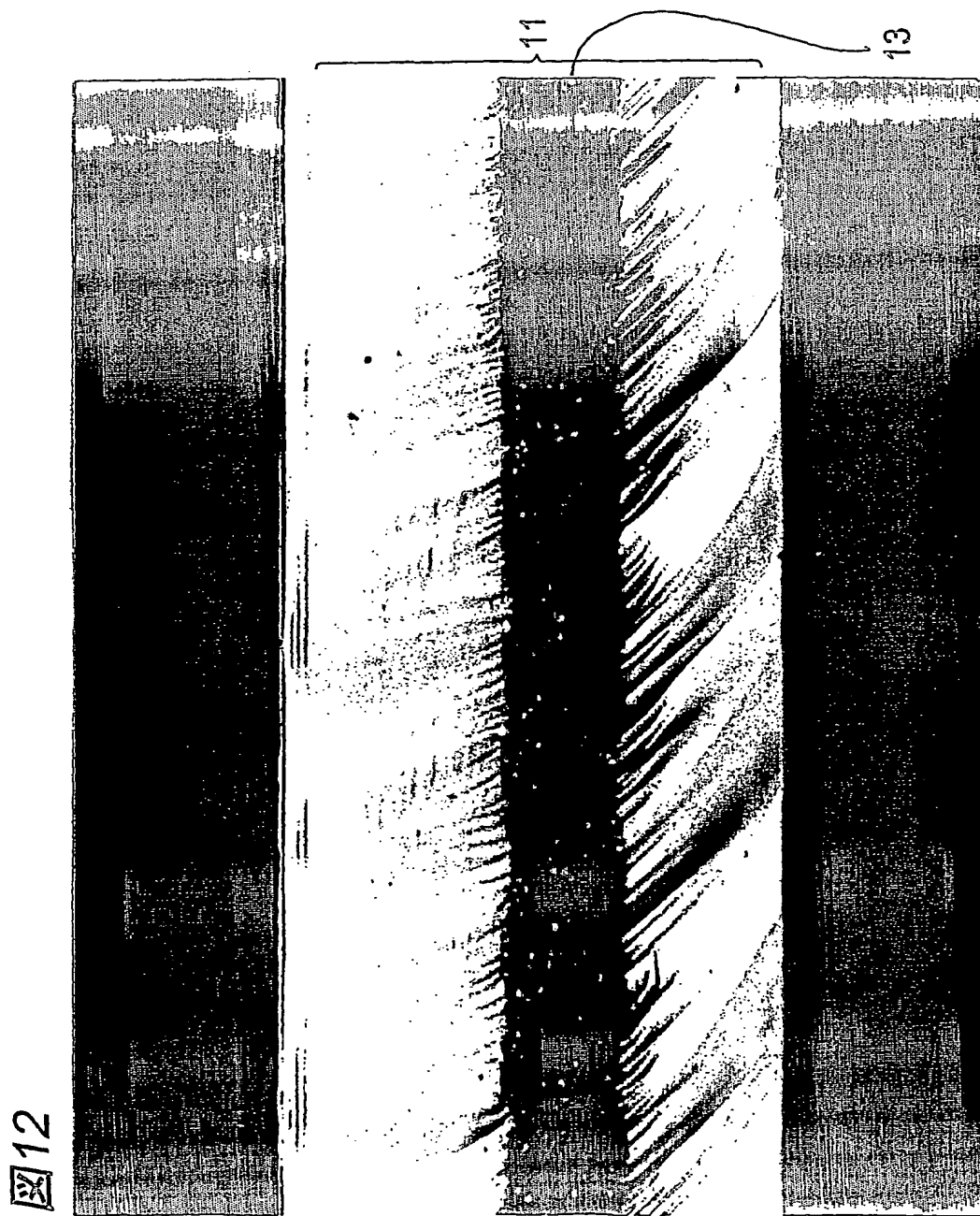


図13

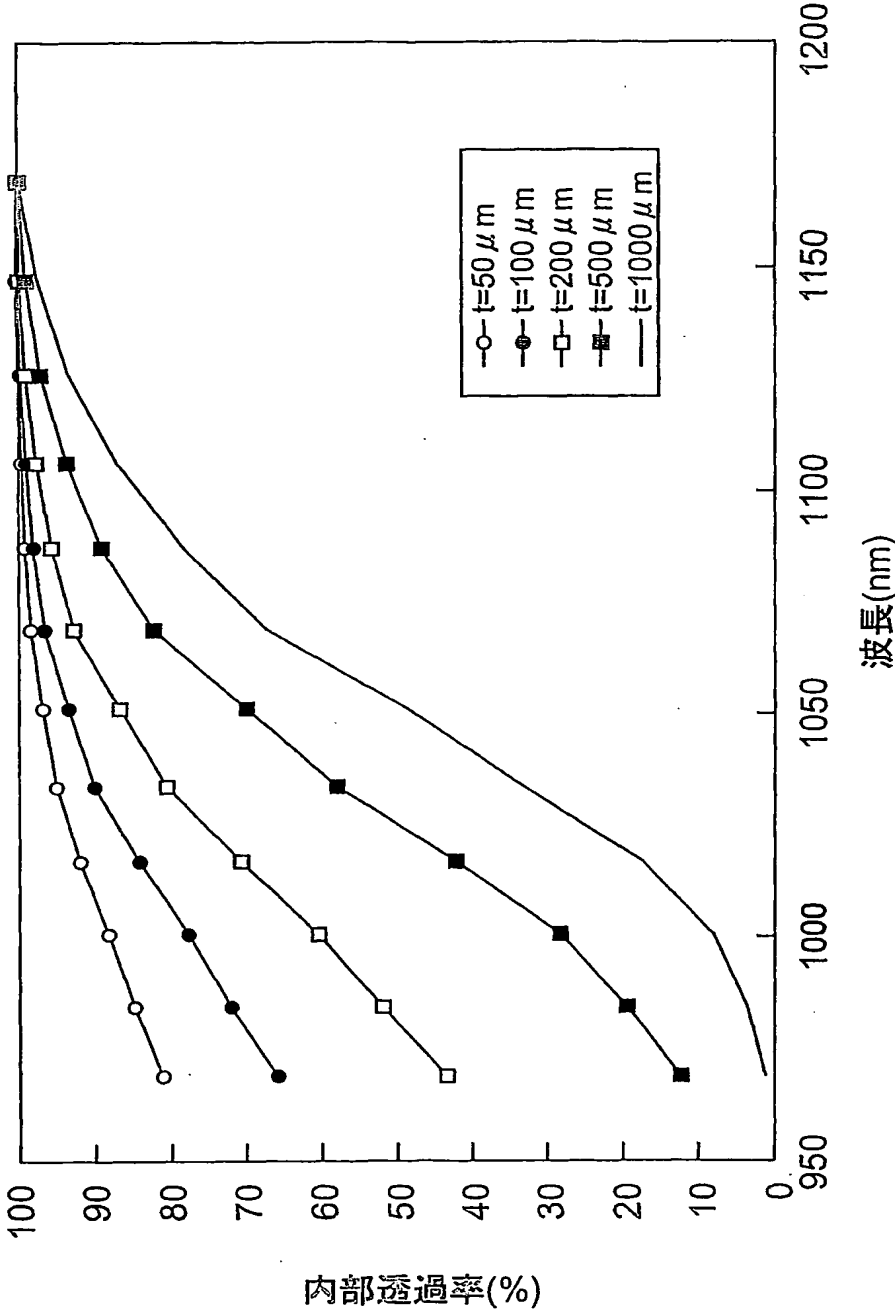


図14

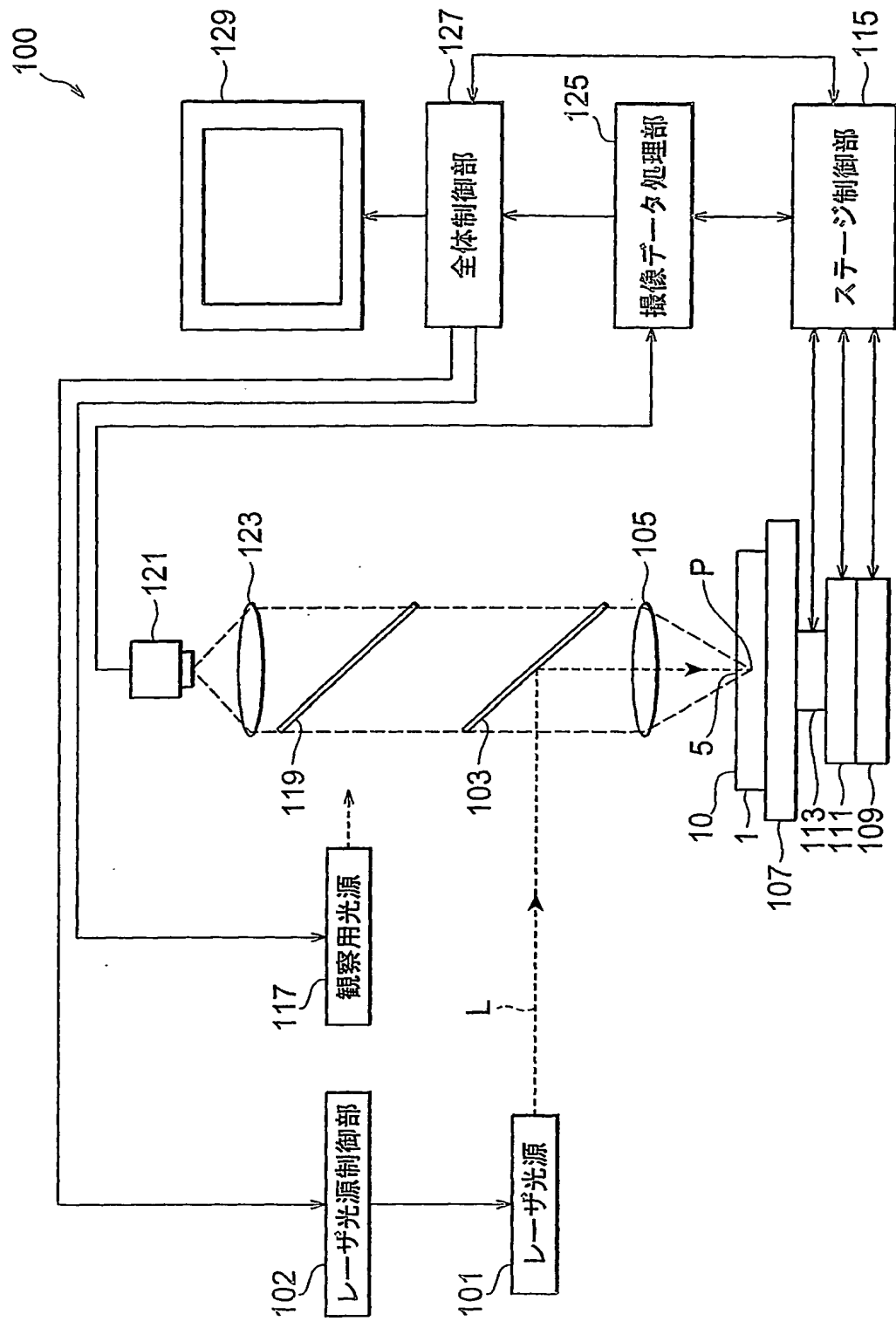


図15

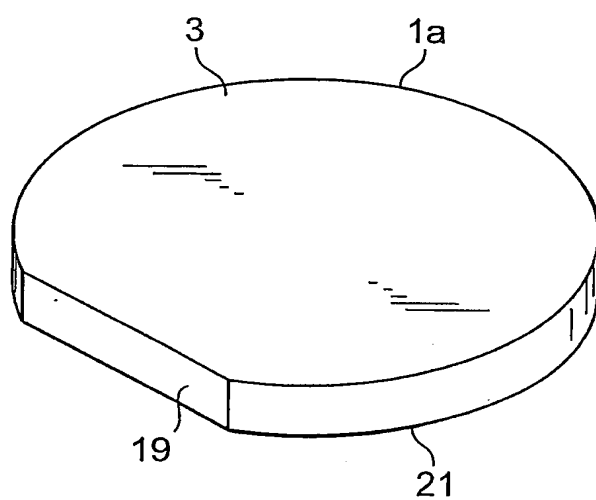


図16

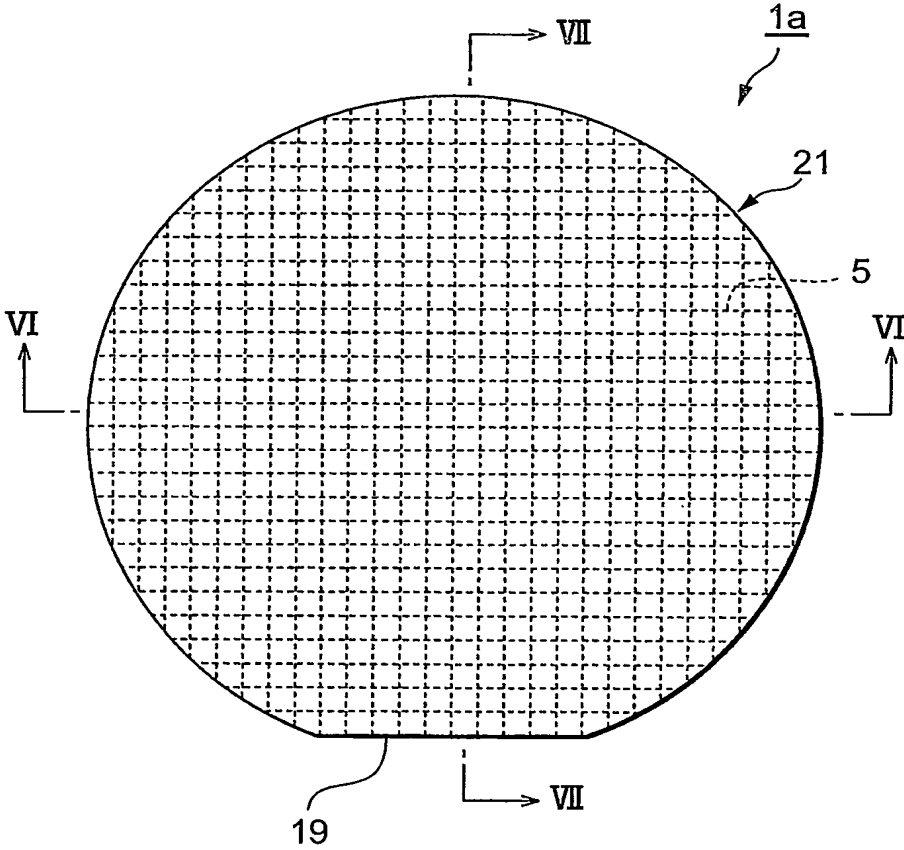


図17

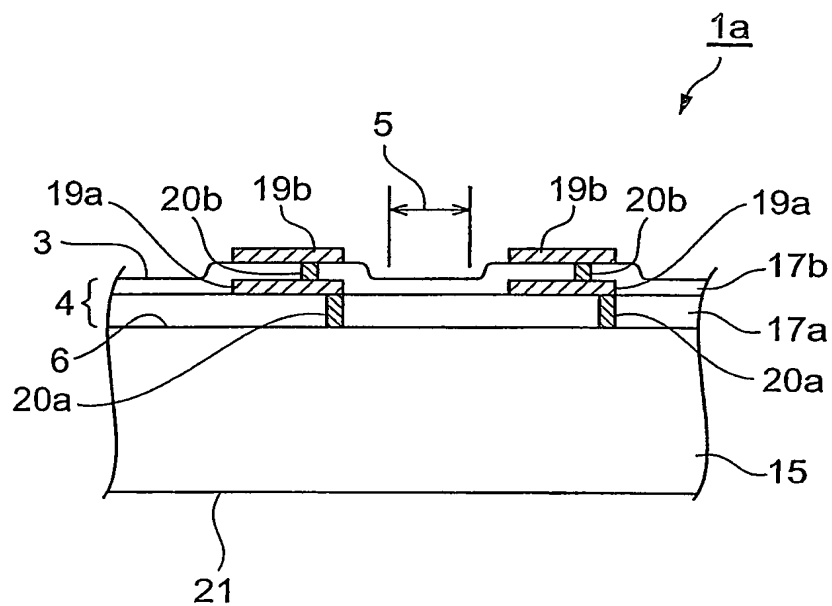


図18

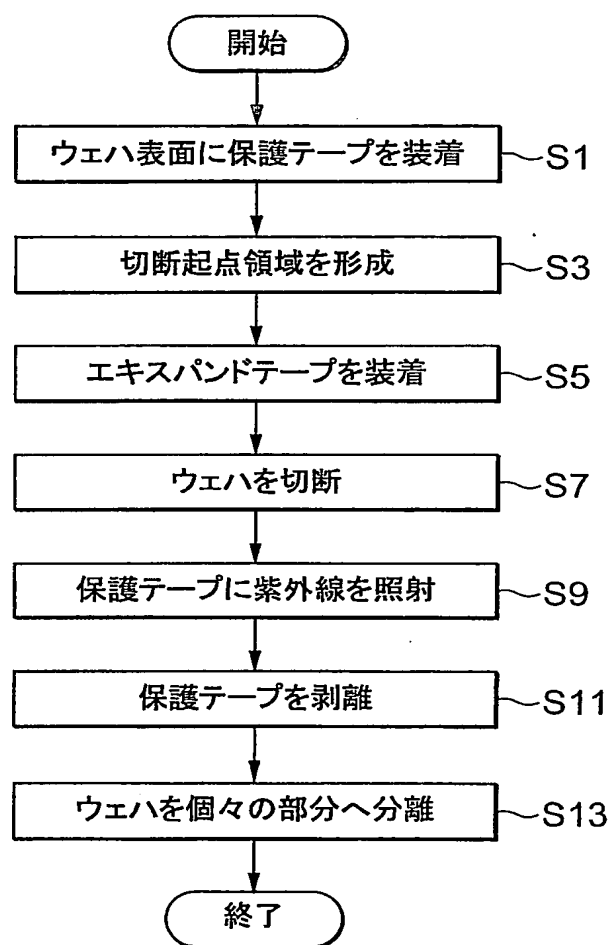
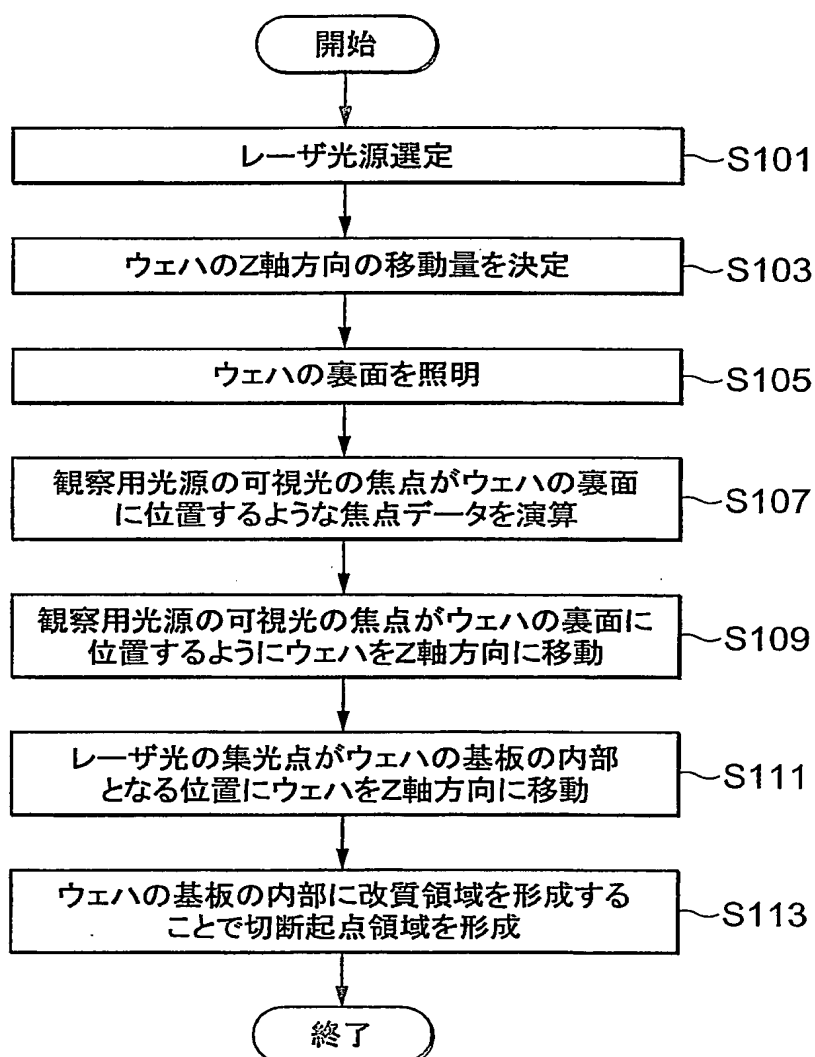


図19



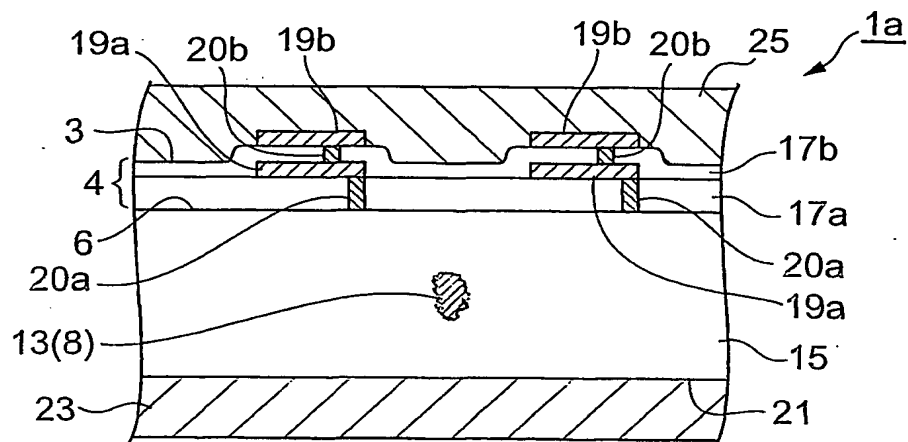
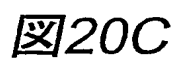
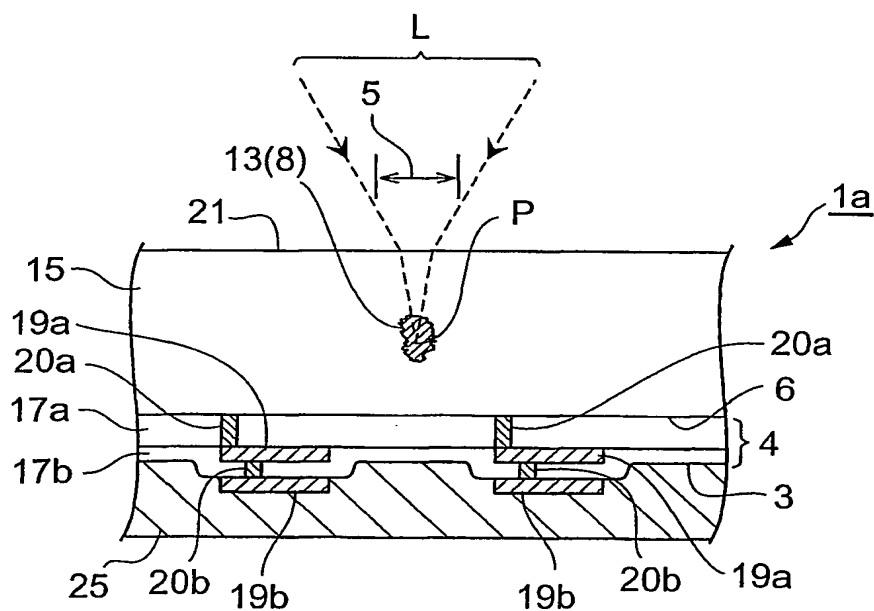
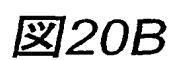
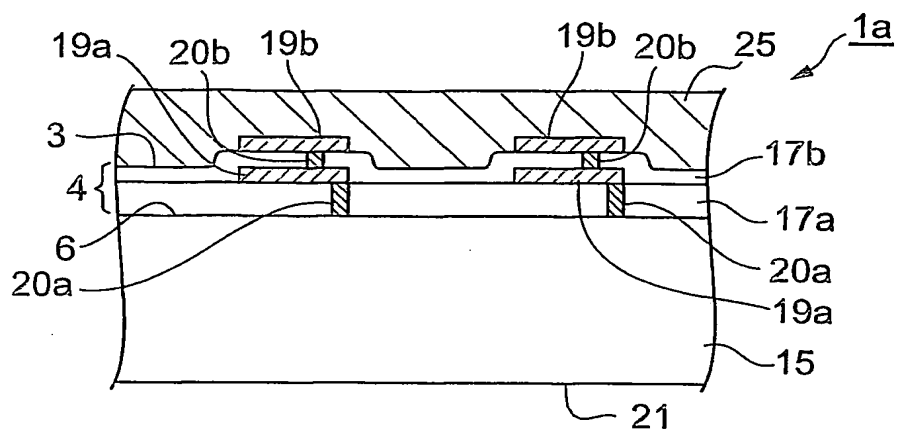


Figure 21A is a schematic diagram of a rectangular structure. It features a central cross-like shape formed by two intersecting lines. At each of the four corners of the rectangle, there is a small circle. The entire diagram is enclosed in a rectangular border.

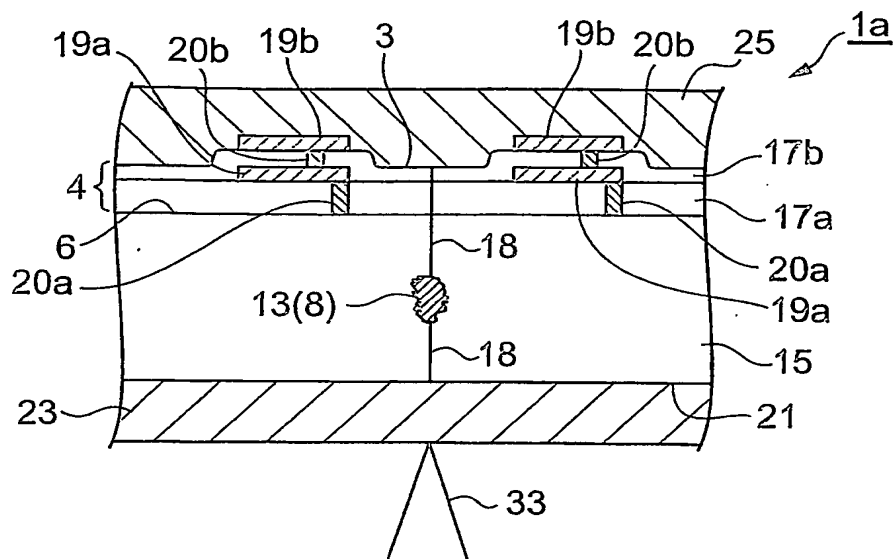


図21B

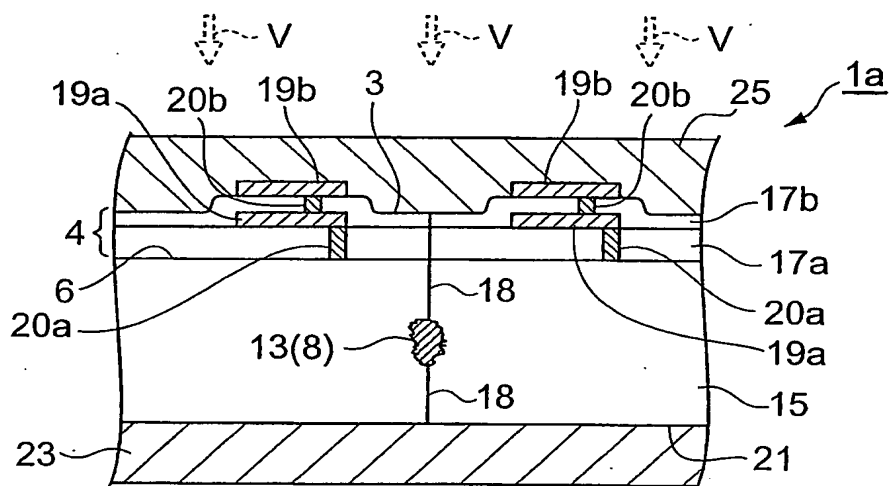


図21C

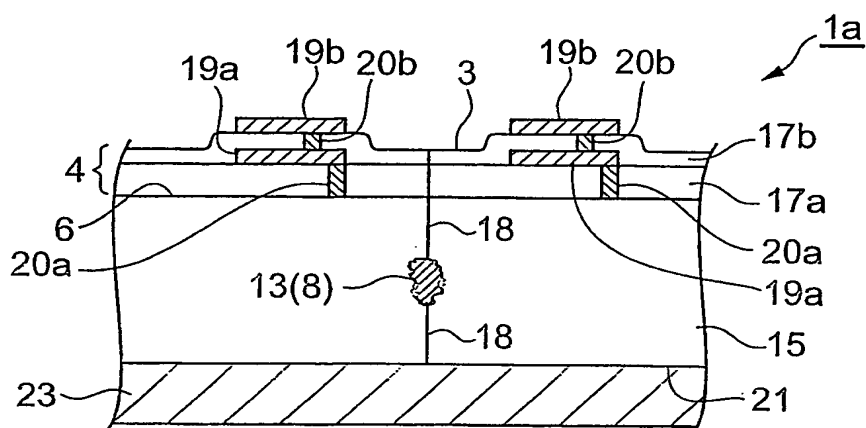
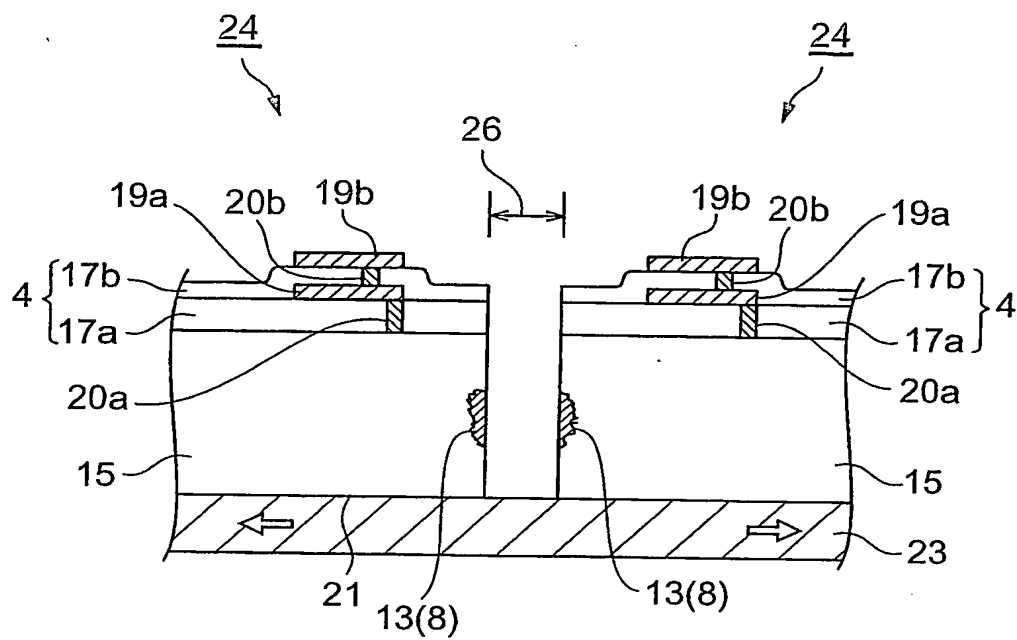


Figure 22 is a cross-sectional view of a semiconductor device. The device consists of two symmetrical cells separated by a central channel. Each cell is formed on a substrate 15. The top layer of each cell is a stack of layers 17a and 17b, collectively labeled as 4. Below this stack is a layer 20a. On top of layer 20a, there is a structure 20b, which is further divided into regions 19a and 19b. A central channel 26 is formed between the two cells. The bottom of the device is a layer 23, which is divided into regions 21 and 13(8). Arrows indicate the direction of light or signal flow through the device.



23

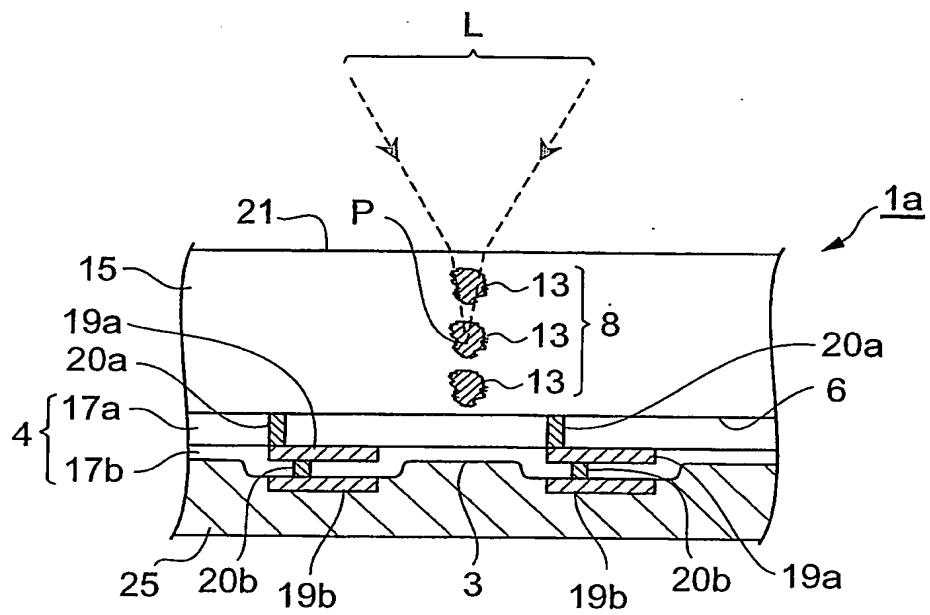


図24

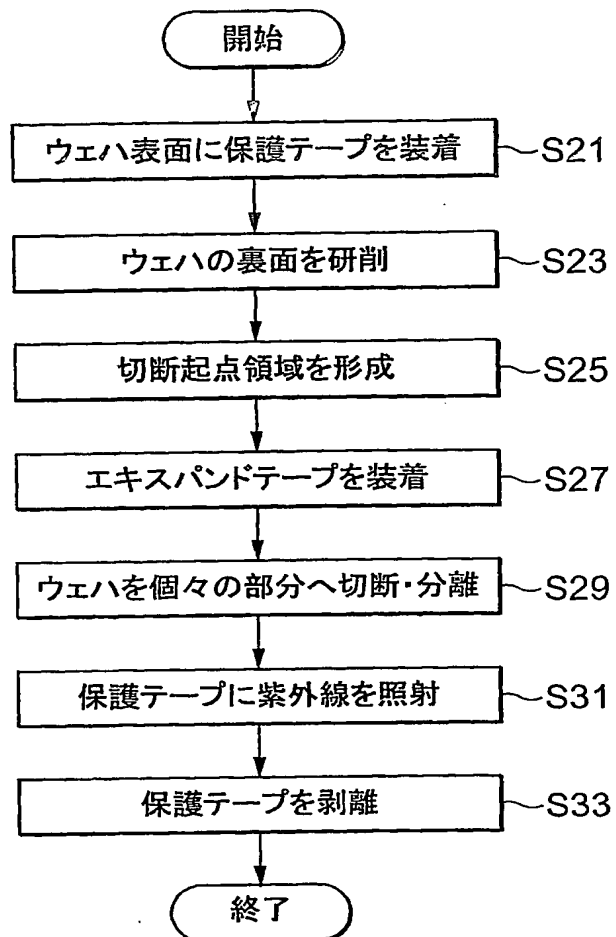


図26A

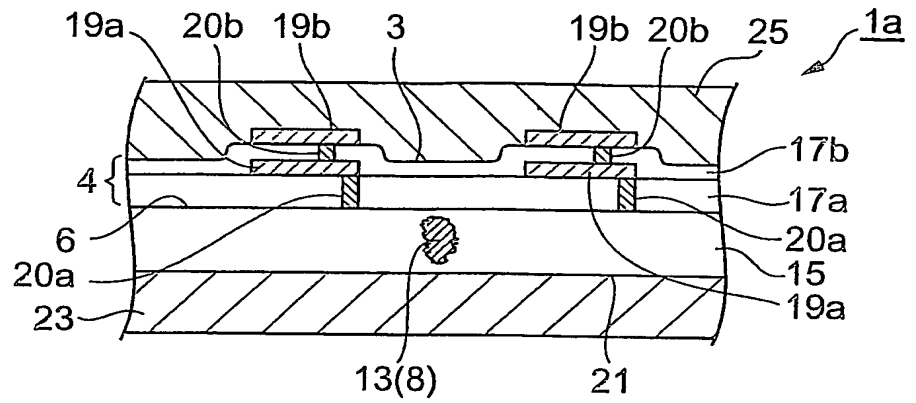


図26B

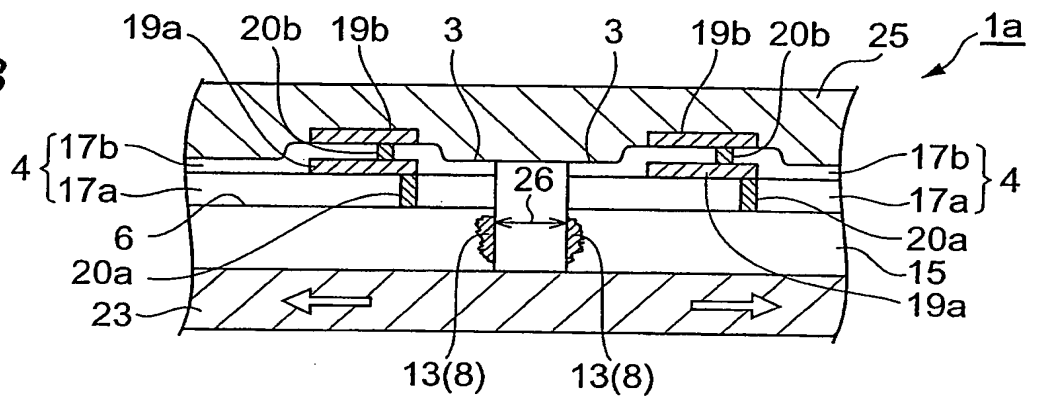


図26C

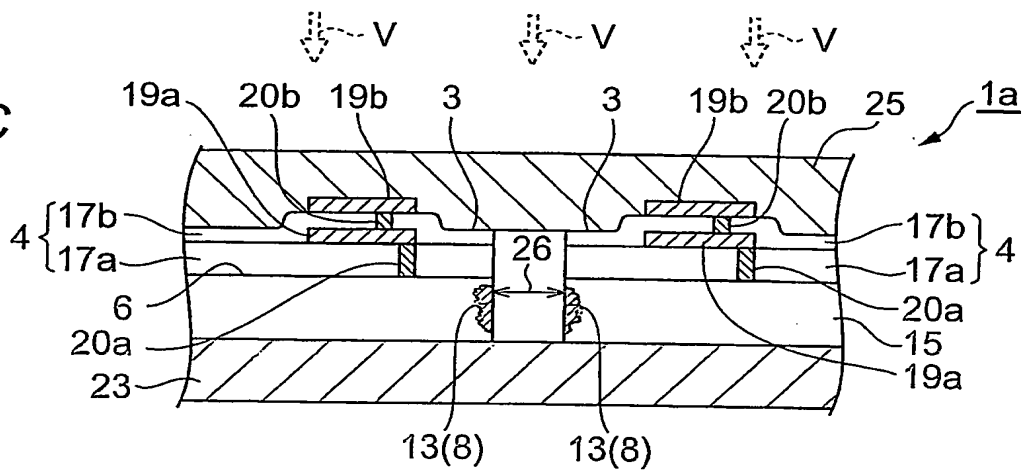


圖 27

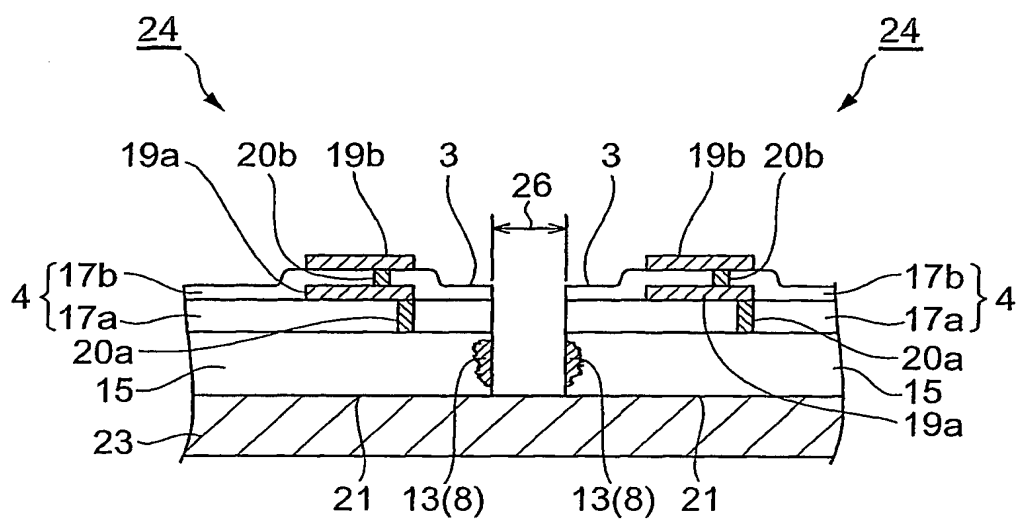


図28

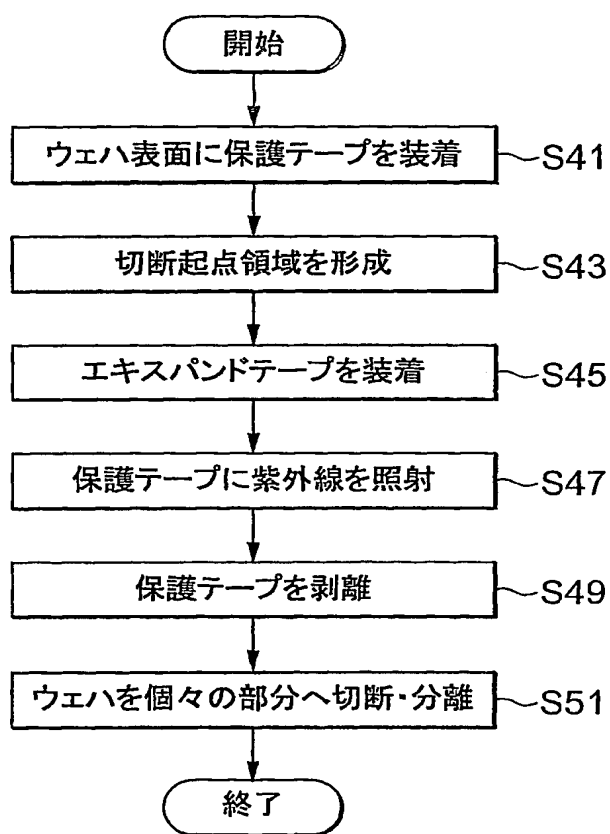
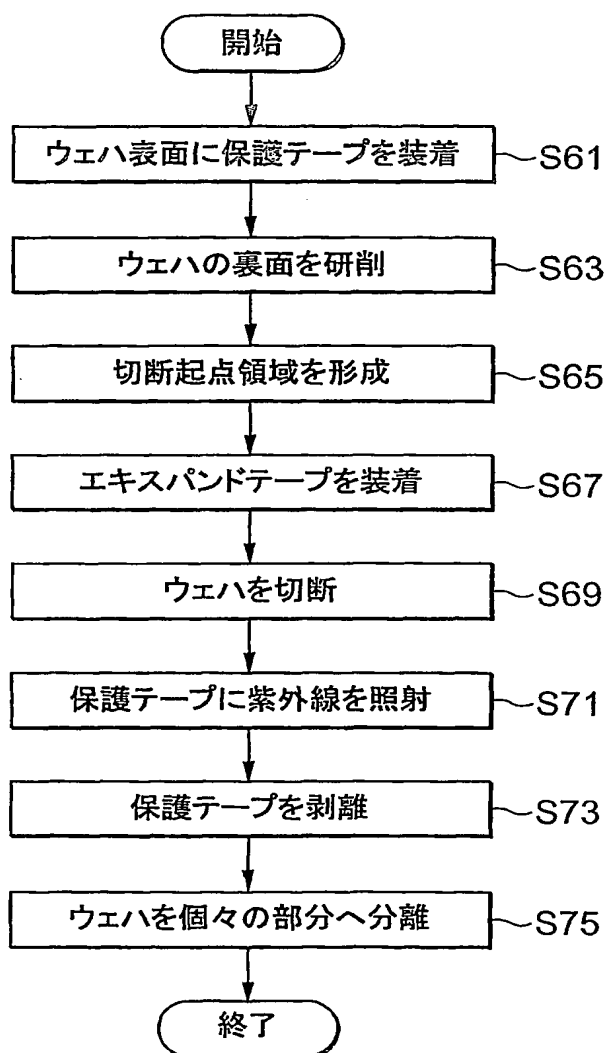


図29



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11626

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/301, B28D5/00, B23K26/38, B23K101:40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/301, B28D5/00, B23K26/38, B23K101:40

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2002-192370 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 10 July, 2002 (10.07.02), Full text; all drawings & EP 1338371 A1	1-9
Y	JP 9-17756 A (Toshiba Corp.), 17 January, 1997 (17.01.97), Par. Nos. [0002], [0026] to [0034] (Family: none)	1-9
Y	JP 2002-226796 A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 14 August, 2002 (14.08.02), Par. No. [0112]; Fig. 6 (Family: none)	1-9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 December, 2003 (17.12.03)Date of mailing of the international search report
13 January, 2004 (13.01.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/11626

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 7-37840 A (NEC Corp.), 07 February, 1995 (07.02.95), Par. Nos. [0014] to [0019] (Family: none)	1-9
Y	JP 60-55640 A (Sanyo Electric Co., Ltd.), 30 March, 1985 (30.03.85), Page 2, upper right column, lines 1 to 18 (Family: none)	1-9
A	JP 11-221684 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 17 August, 1999 (17.08.99), (Family: none)	1-9

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO3/11626

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ H01L21/301 B28D5/00 B23K26/38 B23K101:40

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ H01L21/301 B28D5/00 B23K26/38 B23K101:40

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2003年

日本国登録実用新案公報 1994-2003年

日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 2002-192370 A (浜松ホトニクス株式会社) 2002.07.10, 全文, 全図 & EP 1338371 A1	1-9
Y	JP 9-17756 A (株式会社東芝) 1997.01.17, 【0002】, 【0026】 - 【0034】 (ファミリーなし)	1-9
Y	JP 2002-226796 A (日立化成工業株式会社) 2002.08.14, 【0112】, 図6 (ファミリーなし)	1-9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17.12.03

国際調査報告の発送日

13.01.04

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

紀本 孝

3 P

8815

電話番号 03-3581-1101 内線 3363

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P 7-37840 A (日本電気株式会社) 1995. 02. 07, 【0014】-【0019】 (ファミリーなし)	1-9
Y	J P 60-55640 A (三洋電機株式会社) 1985. 03. 30, 第2頁右上欄第1-18行 (ファミリーなし)	1-9
A	J P 11-221684 A (浜松ホトニクス株式会社) 1999. 08. 17 (ファミリーなし)	1-9